



ลัษณญาณเลขที่ R2562B064

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลของการเติม Fe_2O_3 ต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก
ของเซรามิก $(\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03})(\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06})\text{O}_3$ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไฟน้ำ

Effect of Fe_2O_3 Doping on Phase Formation, Microstructure, Electric and
Magnetic Properties of $(\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03})(\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06})\text{O}_3$ Ceramics Synthesized by
Combustion Method



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภารพรรณ ชูถิน
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ ๑๕๓๗๘๔
๑๐๓๙๗๖๐
๖๐
๕๙๕
.๕
๗๗๑๖
๒๕๖๒

สนับสนุนโดยงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีงบประมาณ 2562

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีงบประมาณ 2562 ผู้วิจัยและคณาจารย์ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านที่อำนวย
ความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

ขอขอบคุณ Science Lab Center คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทำวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภารพรณ ชูถิน และคณา-



หัวข้อวิจัย

ผลของการเติม Fe_2O_3 ต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก $(\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03})(\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06})\text{O}_3$ ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาใหม่

นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภพรรรณ ชูถิน

บทคัดย่อ

สังเคราะห์เซรามิก $\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03}\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06}\text{O}_3$ ที่เติม Fe_2O_3 ($\text{BCTS}-x\text{Fe}$; $x=0-0.5$ wt.%) ด้วยเทคนิคการเผาใหม่แบบสถานะของแข็ง ศึกษาการเติม Fe_2O_3 ในปริมาณเล็กน้อยที่มีผลต่อพัฒนาการโครงสร้างเฟส, โครงสร้างจุลภาค, สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิก BCTS พบว่าเมื่อเติม Fe_2O_3 โครงสร้างเปลี่ยนจากเฟสร่วมระหว่างเทรอโนนัลและօร์โธอมบิกเป็นซูโดคิวบิก โดยขนาดกรานและลักษณะอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณ Fe_2O_3 เพิ่มขึ้น เซรามิก $\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03}\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06}\text{O}_3$ ที่เติม Fe_2O_3 แสดงพฤติกรรมแม่เหล็กแบบพารา ในส่วนอุณหภูมิเปลี่ยนเฟสพบว่าอุณหภูมิครูรีเลื่อนมาอย่างอุณหภูมิที่ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อปริมาณการเติม Fe_2O_3 เพิ่มขึ้น



Research Topic: Effect of Fe_2O_3 Doping on Phase Formation, Microstructure, Electric and Magnetic Properties of $(\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03})(\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06})\text{O}_3$ Ceramics Synthesized by Combustion Method
Researcher: Asst. Prof. Suphornphun Chootin

Abstract

$\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03}\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06}\text{O}_3$ ceramics with Fe_2O_3 doping (BCTS-xFe ; $x = 0\text{-}0.5 \text{ wt.\%}$) were synthesized via the solid-state combustion technique. The influence of a small amount Fe_2O_3 doping on the structural evolution, microstructure electrical and magnetic properties of BCTS ceramics was investigated. We found that the increase Fe_2O_3 content changed the crystal structure from coexistent phase (between tetragonal and orthorhombic) to pseudo-cubic. The grain size decreased rapidly with increasing the Fe_2O_3 content. The BCTS ceramics with Fe_2O_3 doping displayed the paramagnetic characteristic. Curie temperature moves to lower temperature and the dielectric constant significantly reduced with increase of Fe_2O_3 doping.

บทที่ 1 บทนำ

1.1. ความเป็นมาของปัญหา

เซรามิกไโพโซอิเล็กทริกมีความสำคัญอย่างมากในการประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับสัญญาณ (sensor) ตัวขับเร้า (actuator) ตัวแปลงสัญญาณ (transducer) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซรามิกไโพโซอิเล็กทริกที่นำมาประยุกต์ใช้โดยส่วนใหญ่มีตะกั่ว (Pb) เป็นองค์ประกอบหลักมีค่ากว่า 60% ตัวอย่างเช่น PT, PZT, หรือ PMN ซึ่งในระหว่างกระบวนการผลิตและการจำจัดเซรามิกดังกล่าวก่อให้เกิดการระเหยของออกไซด์ของตะกั่ว (PbO และ Pb_3O_4) ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และถึงแวดล้อมอย่างมาก [1-2] ด้วยเหตุนี้ คณะวิจัยจำนวนมากจึงศึกษาและพัฒนาเซรามิกไโพโซอิเล็กทริกที่ปราศจากสารตะกั่วที่มีสมบัติใกล้เคียง เซรามิกที่มีสารตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักขึ้นมาทดแทน เซรามิก $(Ba_{0.97}Ca_{0.03})(Ti_{0.94}Sn_{0.06})O_3$ (BCTS) เป็นเซรามิกไโพโซอิเล็กทริกชนิดหนึ่งที่แสดงโครงสร้างเฟสร่วมระหว่างออร์โรรมบิกและเทหะโนกัลซึ่ง ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากเซรามิก BCTS มีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี เช่น ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง ($\epsilon_r = 4900$) ค่าสัมประสิทธิ์ไโพโซอิเล็กทริก ($d_{33} \sim 500 \text{ pC/N}$) และสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก ($P_r \sim 12.74 \mu\text{C/cm}^2$ และ $E_c \sim 1.60 \text{ kV/cm}$) สูง แต่อย่างไรก็ตามเซรามิก BCTS มีอุณหภูมิคิวเรที่ต่ำมาก ($T_c \sim 60$ องศาเซลเซียส) และใช้อุณหภูมิในการแคลโลไซน์และซินເຕോร์สูง (1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และ 1500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตามลำดับ) [3]

งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าอุณหภูมิซินເຕോร์ อุณหภูมิคิวเรท ค่าความหนาแน่น สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิกที่มีโครงสร้างแบบเพอร์ฟาร์ตสามารถปรับปรุงได้โดยการเติม Fe_2O_3 ในปริมาณที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ชีระชัย บงการณ์และคณะ [4] พบร่องการเติมเหล็ก (Fe_2O_3) ปริมาณ 0.6wt% ลงในเซรามิก $(K_{0.44}Na_{0.52}Li_{0.04})(Nb_{0.84}Ta_{0.10}Sb_{0.06})O_3$ (KNLNTS) สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นแม่เหล็กในเซรามิก ($M_r = 0.015 \text{ emu/g}$ และ $H_c = 143 \text{ Oe}$) อีกทั้งยังเหนี่ยวนำทำให้เกิดสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี โดยมีค่าไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง ค่าโพลาไรเซชันคงค้าง และค่าไโพโซอิเล็กทริก เป็น 2782, 27.9 $\mu\text{C/cm}^2$ และ 311 pC/N ตามลำดับ (สูงกว่า KNLNTS บริสุทธิ์ 432, 8 $\mu\text{C/cm}^2$ และ 116 pC/N ตามลำดับ) นอกจากนี้ยังพบว่าเซรามิกที่เติม Fe_2O_3 แสดงค่าความหนาแน่นสูงกว่าเมื่อเทียบ กับเซรามิก KNLNTS บริสุทธิ์ Jinming Guo และคณะพบว่าการเติม Fe_2O_3 ที่ปริมาณ 0.20 mol% ในระบบเซรามิก $[K_{0.43}Na_{0.57}]_{0.94}Li_{0.06}][Nb_{0.94}Sb_{0.06}]_{0.95}Ta_{0.05}]O_3$ ด้วยวิธีปฏิกริยาสถานะของแข็ง เซรามิก ที่ได้แสดงค่าโพลาไรเซชันคงค้าง ($P_r \sim 20 \mu\text{C/cm}^2$) และไโพโซอิเล็กทริก ($d_{33} \sim 306 \text{ pC/N}$) สูง จาก

งานวิจัยข้างต้นพบว่าการเติม Fe_2O_3 ลงในระบบเซรามิก สามารถปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิกได้ [5] เมื่อเร็วๆนี้ การสังเคราะห์เซรามิกด้วยวิธีการเผาใหม่เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากอนุภาคที่ได้หลังจากการแคลไชน์มีขนาดเล็กอยู่ในระดับนาโนซึ่งเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารตั้งต้นในระดับโมเลกุลอย่างรวดเร็วที่ได้จากการปลดปล่อยพลังงานที่ได้จากการฉุดระเบิด ทำให้การสังเคราะห์เซรามิกใช้อุณหภูมิต่ำกว่าวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการเผาเช่นนี้ทำให้ผงผลึกที่ได้มีองค์ประกอบทางเคมีตามที่ต้องการ

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาผลของปริมาณ Fe_2O_3 ในปริมาณ 0 ถึง 0.5 wt% ที่มีต่อโครงสร้างไฟฟ้าโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก ($\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03}(\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06})\text{O}_3$ (BCTS) ที่เตรียมด้วยวิธีการเผาใหม่

1.2. จุดมุ่งหมายของการศึกษา

เพื่อศึกษาผลของปริมาณการเติม Fe_2O_3 ในปริมาณ 0 ถึง 0.5 wt% ในเซรามิก BCTS ที่มีผลต่อโครงสร้างไฟฟ้าโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็ก

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1.3.1 สังเคราะห์เซรามิก BCTS ที่มีการเติม Fe_2O_3 ในปริมาณ 0 ถึง 0.5 wt% (BCTS-x Fe_2O_3) ด้วยวิธีการเผาใหม่แบบสถานะของแข็ง โดยใช้อุณหภูมิแคลไชน์เป็น 1100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และชีนเตอร์เป็น 1400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

1.3.2 วิเคราะห์โครงสร้างด้วยเครื่องเลี้ยวเบนริงส์ (XRD) และโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒 (SEM) เพื่อศึกษาสมบัติทางไฟฟ้า (ไดอิเล็กทริก เฟรโรอิเล็กทริก) และสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิก BCTS-x Fe

1.3.3 จัดทำรูปเล่ารายงานและนำเสนองานวิจัย

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถสังเคราะห์เซรามิก BCTS ที่มีการเติม Fe_2O_3 ในปริมาณ 0 ถึง 0.5 wt% ด้วยวิธีการเผาใหม่แบบสถานะของแข็งได้ รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของปริมาณ Fe_2O_3 ที่มีผลต่อวิัฒนาการไฟโครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กได้

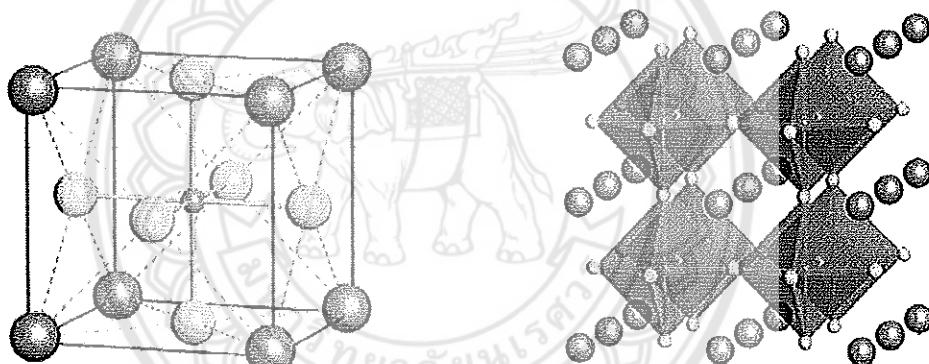
บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 โครงสร้างเพอร์อฟส์ไกต์ (perovskite structure)

โครงสร้างเพอร์อฟส์ไกต์มีสูตรทางเคมี คือ ABO_3 ประกอบด้วยอะตอมของไอออนบวกที่มีรัศมีอะตอมขนาดใหญ่กว่าตัวอยู่ที่ตำแหน่ง A (A-site) ซึ่งอยู่ที่มุ่งทุกมุมของหน่วยเซลล์ (unit cell) และมีค่าความเป็นประจุไฟฟ้าต่ำกว่า อาร์เซนิ K^+ , Na^+ , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} และ Pb^{2+} ส่วนที่ตำแหน่ง B (B-site) ซึ่งอยู่ตรงกลางของหน่วยเซลล์จะมีอะตอมของไอออนบวกที่มีรัศมีอะตอมขนาดเล็กและมีค่าความเป็นประจุไฟฟ้าสูงกว่า อาร์เซนิ Ta^{5+} , Ti^{4+} , Zr^{4+} และ Sn^{4+} โดยไอออนบวกนี้จะถูกล้อมรอบด้วยไอออนลบของออกซิเจน 6 ตัวจับตัวกันเป็นรูปอโກตระหีดรول (octahedral) ดังแสดงในรูปที่ 1



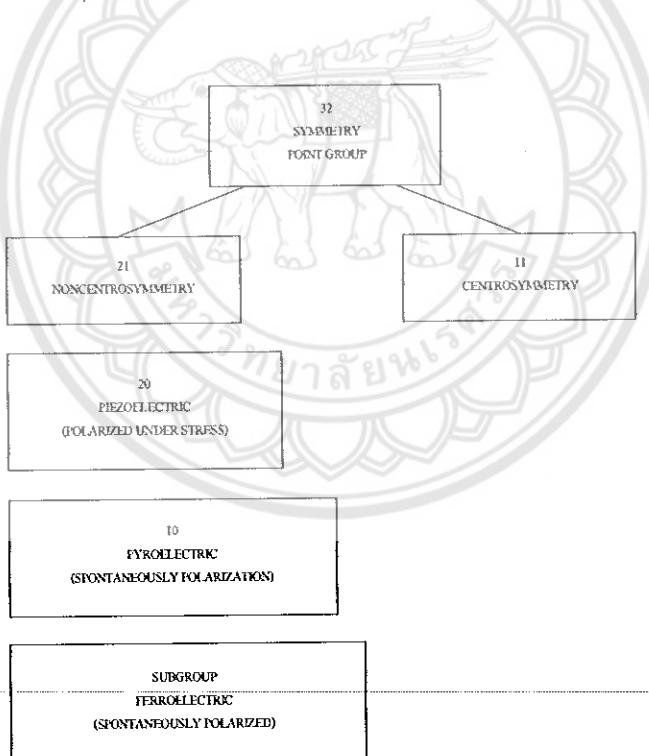
รูปที่ 2.1 แสดงโครงสร้างแบบเพอร์อฟส์ไกต์ (ABO_3)

2.1.2 ไฟอิโซอิเล็กทริก (Piezoelectric) [6]

คำว่า “ไฟอิโซ (piezo)” มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “กด” ดังนั้นสมบัติไฟอิโซอิเล็กทริก คือ การเกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการได้รับแรงกล ซึ่งเป็นแรงทางกลประภูมิการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริก (piezoelectric) ได้ถูกค้นพบครั้งแรกโดย ชองส์ และปีแอร์ คูรี (Jacques and Pierre Curie) ในปี ค.ศ.1880 ขณะที่ศึกษาผลของการดันต่อประจุไฟฟ้าของผลึกบางประเภท เช่น ควอตซ์ (quartz) ซิงค์

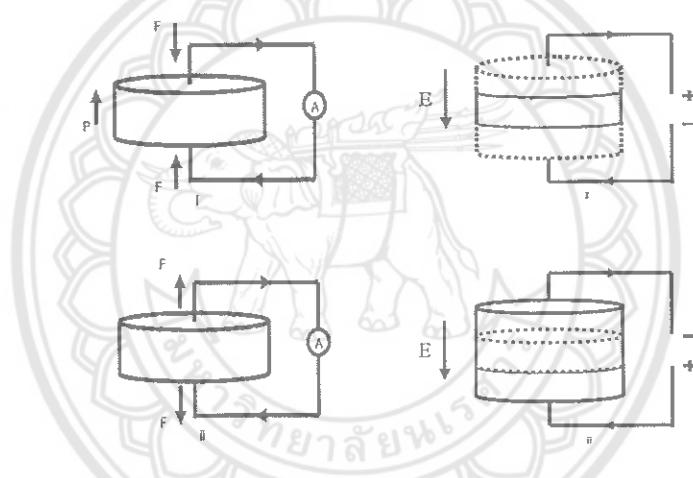
เบلن (zincblende) หัวมาลีน (tourmaline) การเกิดกระแสไฟฟ้าที่เป็นผลมาจากการได้รับแรงกดซึ่งเป็นแรงทางกลทำให้เกิดความเครียด (strain) ในผลึก มีผลทำให้เกิดการจัดเรียงตัวของไดโพลโมเมนต์ (dipole moment) ไปในทิศทางเดียวกันเรียกว่า การโพลาไรเซชัน (polarization) และให้กระแสไฟฟ้าออกมาน โดยปริมาณและเครื่องหมายของการโพลาไรเซชันจะแปรผันตามความเครียดที่ได้รับ และในทางกลับกันเมื่อให้สนามไฟฟ้าแก่สารจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือความเครียด ขึ้นในสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป

ความเข้าใจในโครงสร้างภายในของวัสดุนี้ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาสมบัติไฟอิเล็กทริกของของแข็ง เมื่อทำการพิจารณาวัสดุที่มีผลึกเดียวพบว่า ผลึกมีองค์ประกอบทางเคมีคงที่ และประกอบด้วยไอออน (อะตอมที่มีประจุ) เรียกว่า ก้อนซ้า (lattice) หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความสมมาตร เรียกว่า หน่วยเซลล์ (unit cell) และเป็นตัวบ่งบอกความเป็นไปได้ของ การมีสมบัติไฟอิเล็กทริกในผลึก เนื่องจากความสามารถของโครงสร้างผลึกภายในการถูกสะท้อนด้วยความสมมาตรของสมบัติที่วัสดุนี้แสดงออก



รูปที่ 2.2 การแบ่งกลุ่มของผลึกของวัสดุใน 32 กลุ่ม

นักผลีกศาสตร์แบ่งผลีกออกเป็น 32 กลุ่ม ดังแสดงในรูป 2 จากผลีก 32 กลุ่ม ดังกล่าวมี 21 กลุ่ม ที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง (noncentrosymmetric) ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกซึ่งพบถึง 20 กลุ่ม อีกหนึ่งกลุ่มที่เหลือไม่มีสภาพเป็นไฟอิโซอิเล็กทริกแม้จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีสมมาตรของศูนย์กลาง เพราะเกิดปรากฏการณ์พิเศษบางอย่าง การไม่มีสมมาตรของศูนย์กลางเป็นสภาวะสำคัญที่ทำให้เกิดสภาพไฟอิโซอิเล็กทริกเนื่องจากแรงกดที่ให้กับวัสดุเป็นแบบที่มีสมมาตรของศูนย์กลาง และไม่สามารถทำให้เกิดการโพลาไรเซชัน เช่น การเกิดโพลาไรเซชันแบบเวกเตอร์ (vector-quality-like Polarization) นอกจากวัสดุนี้จะมีลักษณะไม่มีสมมาตรของศูนย์กลางอยู่ ซึ่งจะทำให้ผู้รวมของการเคลื่อนที่ของประจุบวกและลบสามารถสร้างได้โพลาไฟฟ้าขึ้นมา หรือที่เรียกว่าเกิดโพลาไรเซชันนั่นเอง ความแตกต่างของวัสดุที่เป็นไฟอิโซอิเล็กทริกกับเฟอร์โรอิเล็กทริก คือ วัสดุไฟอิโซอิเล็กทริกไม่สามารถเกิดโพลาไรเซชันด้วยตัวมันเอง แต่จะเกิดเมื่อให้แรงทางกลต่อผลีกเท่านั้น



รูปที่ 2.3 แสดงปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริก (ก) แบบ direct effect (ข) แบบ converse effect

สภาพไฟอิโซอิเล็กทริกเกิดขึ้นได้สองแบบ คือ แบบที่เป็นเส้นตรง (direct effect) และแบบผันกลับได้ (converse effect) ซึ่งแบบแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชันเมื่อสารถูกแรงกลกระทำ (หรือเกิดความเค้น) เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า เป็นปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกแบบ direct effect เช่น เครื่องกำเนินสัญญาณ (generator) สำหรับแบบหนึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดและปริมาตร (หรือเกิดความเครียด) ในสนามไฟฟ้าที่ให้เข้าไป เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ไฟอิโซอิเล็กทริกแบบ converse effect เช่น มอเตอร์ (motor) ซึ่งกลไกทั้งสองแบบแสดงในรูปที่ 3 และระดับการเกิดโพลาไรเซชันจะขึ้นกับระดับความเครียดที่เกิดจากแรงที่ได้รับ และเครื่องหมายของประจุที่เกิดขึ้นอยู่กับว่าแรงที่ให้เป็นแรงดึงหรือแรงกดสมบัติต่างกันว่าอาจจะพบรได้ในไฟอิโซอิเล็กทริกเชรนิก ซึ่งก็คือ เฟอร์โรอิเล็กทริกที่ผ่านการสร้างข้าว (poling) นั่นเอง ในระหว่างกระบวนการสร้างข้าววัสดุจะเกิดการขยายตัวตามแนวแกน

การสร้างข้าวเล็กน้อย และเกิดการหดตัวในทิศทางที่ตั้งจากกับทิศทางเล็กน้อยเช่นกัน ระดับความแรงของสนามที่สร้างขึ้นและอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดการจัดทิศทางและสมบัติที่ได้ของวัสดุ การจัดเรียงตัวไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์และโครงสร้างผลึกของวัสดุก็เป็นสิ่งที่บอกระดับการสร้างข้าวได้ด้วย เช่น เฟสเทหารโนนัล ทำได้ถึงร้อยละ 83 เฟสรองโนบีซีดรอลทำได้ถึงร้อยละ 86 และสำหรับเฟสออร์ ไฮโรบิก มากรถึงร้อยละ 91 ซึ่งเป็นค่าที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการผลักเดียวหรือโดยเมนเดีย กล่าวได้ว่าเซรามิกทุกชนิดที่ผ่านการเผาเผา (sintering) แล้วจะมีสภาพเมื่อมองโดยรวมมีสมบัติเหมือนกันในทุกทิศทาง (isotropic) และจะต้องผ่านการสร้างข้าวเพื่อทำให้เป็นโพลิโซอิเล็กทริก โดยที่วัสดุเหล่านั้นเป็นทั้งสารเฟรโรอิเล็กทริก และเป็นโพลิโซอิเล็กทริกด้วย กระบวนการสร้างข้าวเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดสภาพไฟอิโซอิเล็กทริกในเซรามิกชนิดเฟรโรอิเล็กทริก หากไม่มีการสร้างข้าวเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพแม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็นไฟอิโซอิเล็กทริกอยู่แล้วก็ตาม เซรามิกที่ผ่านการสร้างข้าวเซรามิกจะไม่เปลี่ยนสภาพแม้ว่าแต่ละผลึกจะเป็นไฟอิโซอิเล็กทริกอยู่แล้วก็ตาม เซรามิกที่ผ่านการสร้างข้าวมีประ予以ชั่นมากมายเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกินอุณหภูมิครี (curie temperature: T_c) เพราะเซรามิกจะเสียสภาพโพลาไรเซชันที่เกิดจากการสร้างข้าวที่อุณหภูมิสูงกว่า T_c จาก 20 point groups ของผลึก noncentrosymmetric ที่เป็นไฟอิโซอิเล็กทริกจะมีอยู่ 10 point groups ที่มีข้าว (polar) เกิดโดยโพลโมเมนต์ได้ด้วยตนเอง แม้มีตัวรับสนามไฟฟ้ากระทำ เรียกกลุ่มสารพุกนี้ว่า สปอนทานเนียส โพลาไรเซชัน (Spontaneous Polarization) ผลึกมีข้าวเหล่านี้เป็นไฟอิโซอิเล็กทริกอย่างมาก และในกรณีที่ให้สนามไฟฟ้าแรง磅ที่เข้าไปจะทำให้ทิศทางของเวกเตอร์โพลาไรเซชัน เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งในสาร point groups นี้เรียกว่า เฟรโรอิเล็กทริก นั่นคือ สารเฟรโรอิเล็กทริกทุกชนิดเป็นสารไฟอิโซอิเล็กทริก แต่ไฟอิโซอิเล็กทริกไม่จำเป็นต้องเป็นเฟรโรอิเล็กทริก ผลึกเฟรโรอิเล็กทริก จะแสดงสมบัติของโมเมนต์คู่ควน (dipole moment) ถึงแม้ว่าเราได้นำสนามไฟฟ้าออกแล้วก็ตาม กล่าวว่ามี ไดโพลโมเมนต์ค่ารออยู่ในผลึก ในสถานะเฟรโรอิเล็กทริก จุดศูนย์กลางของประจุบวกของผลึกไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับประจุลบ เมื่อเราเอาสารไดอิเล็กทริกมาวางในสนามไฟฟ้าจะเกิดโพลาไรเซชัน ขึ้นภายในสารนั้น และเมื่อลดสนามไฟฟ้า ที่ให้จนเป็นศูนย์ โพลาไรเซชันในสารไดอิเล็กทริกจะกลับไปเป็นศูนย์ทันที แต่มีสารบางอย่างเมื่อเราให้สนามไฟฟ้าภายนอกเข้าไปทำให้เกิดมีโพลาไรเซชัน และเมื่อเราลดสนามไฟฟ้าลงจนเป็นศูนย์ โพลาไรเซชันจะไม่เป็นศูนย์ในสารไดอิเล็กแต่มากจะเป็นศูนย์เมื่อ $E = -E_c$ แสดงว่าในสารมีโมเมนต์ข้าวคู่ ถาวรออยู่แล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่าสารนี้แสดงสถานะเป็นเฟรโรอิเล็กทริกและอาจทำให้สารแสดงสถานะเฟรโรอิเล็กทริกโดยไม่ต้องใช้สนามไฟฟ้าเลย แต่เราใช้การลดอุณหภูมิแทน โดยปกติสถานะเฟรโรอิเล็กทริกจะไม่ปรากฏที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่แน่นอนค่าหนึ่งที่เรียกว่าอุณหภูมิวิกฤต (T_c) ที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิวิกฤตนั้น ผลึกจะอยู่ในสถานะพาราอิเล็กทริก (paraelectric)

2.1.3 เฟรโรอิเล็กทริก (Ferroelectric) [7]

สารเฟรโรอิเล็กทริกเป็นสารที่ไม่มีความสามารถกับจุดศูนย์กลางของหน่วยเซลล์ จึงทำให้สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องได้รับแรงกล ซึ่งสามารถแยกสารเฟรโรอิเล็กทริกออกจากวัสดุได้

เล็กทริก ด้วยการตกค้างหรือรีเมาน์ต์ โพลาไรเซชัน (remanent polarization: P_r) เมื่อสนาณไฟฟ้าที่ใส่เข้าไปมีค่าเป็นศูนย์ โดยปกตินั้นโพลาไรเซชัน (P) เป็นผลมาจากการนามไฟฟ้าซึ่งจัดเรียงขึ้นคู่ของ atom (atomic dipole) หรือขั้วโมเลกุล (molecular dipole) อย่างเป็นระเบียบในสารหลายชนิดโพลาไรเซชัน เป็นสัดส่วนโดยตรงกับสนามไฟฟ้า เมื่อสนาณไฟฟ้า \vec{E} มีความเข้มน้อย

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \quad (1)$$

เมื่อ χ_e เป็นค่าคงที่เรียกว่าสภาวะปรับได้ทางไฟฟ้า (electric susceptibility) ของตัวกลาง ค่าของ χ_e ขึ้นกับโครงสร้างทางจุลภาค (microscopic structure) ของสารที่พิจารณาและ ϵ_0 เป็นสภาพยอมของสัญญาากาศ (permittivity of a vacuum) มีค่าคงที่ประมาณ $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ โปรดสังเกตว่าสนาณไฟฟ้า \vec{E} ในสมการ (1) นี้เป็นสนาณไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากส่วนของประจุอิสระและส่วนของโพลาไรเซชันที่สนาณ \vec{E} ผลิตขึ้นเอง

χ_e ไม่มีทิศทาง และการขจัดไฟฟ้า (electric displacement: D) มาจากการกระจายประจุอิสระเท่านั้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ตามสมการ (2)

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad (2)$$

จากสมการ (1) และ (2) จะได้ความสัมพันธ์เป็น

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} \quad (3)$$

ดังนั้นไม่เพียงแต่ P เท่านั้นที่ขึ้นกับ \vec{E} แต่ \vec{D} ก็ขึ้นกับ \vec{E} ด้วยเช่นกัน

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (4)$$

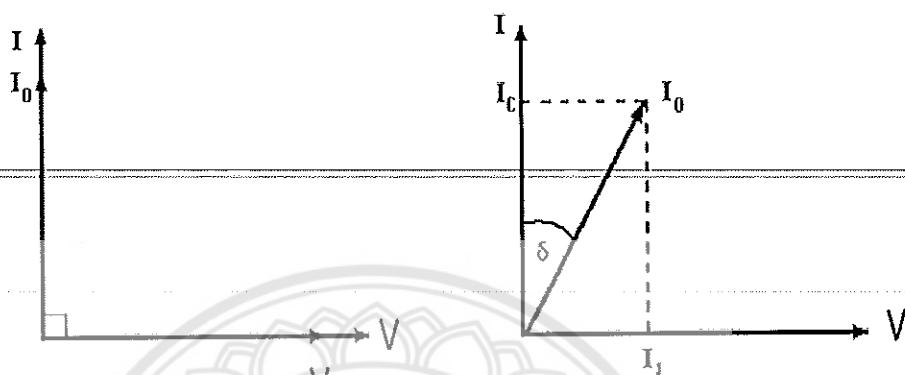
$$\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \quad (5)$$

เรียก ϵ ว่าสภาพยอม (Permittivity) ของวัสดุในสัญญาากาศ ไม่มีสารใดก่อให้เกิดโพลาizer ดังนั้นสภาพยอมไว้ได้ทางไฟฟ้าซึ่งเป็นศูนย์และสภาพยอม (ϵ) จะมีค่าเท่ากับ ϵ_0 และจากสมการ (5) จะได้

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (6)$$

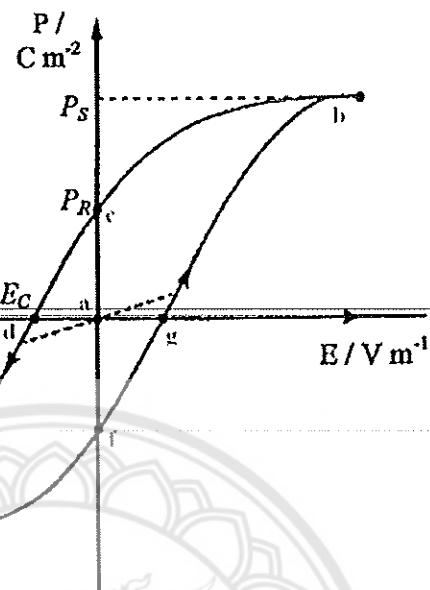
เมื่อ ϵ_r คือ สภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity) หรือ ค่าคงที่โดยอิเล็กทริกในวัสดุ เพื่อร้อยอิเล็กทริก ส่วนใหญ่ค่าคงที่โดยอิเล็กทริก ϵ จะมีค่าสูง ดังนั้น $\vec{P} > \epsilon_0 \vec{E}$ และ $D \approx P$ เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้กับวัสดุโดยอิเล็กทริก สนามไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดเป็นเหตุให้เกิดไฟโพลาภายในวัสดุโดยอิเล็กทริก ในกรณีอุดมคติ ไฟโพลาภายในวัสดุโดยอิเล็กทริกสามารถผลลัพธ์ทิศทางได้ตามความถี่ของแหล่งกำเนิด กรณีกระแสสลับ (I) และศักย์ไฟฟ้า (V) มีความต่างไฟสกันอยู่ 90 องศา ดังรูปที่ 4 (ก) ทำให้ผลคูณสเกลาร์ (scalar product) ของ I และ V เท่ากับศูนย์ ดังนั้นจึงไม่มีการสูญเสียพลังงานของวัสดุ โดยอิเล็กทริก (dielectric loss: $\tan \delta$) เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงการผลลัพธ์ทิศทางของไฟโพลจะก่อให้เกิดความต้านทานภายในเนื้อวัสดุเอง ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานขึ้น ซึ่งกรณีกระแสไฟฟ้ากับศักย์ไฟฟ้ามี

ความต่างไฟสักน้อยกว่า 90 องศา ดังรูปที่ 4 (ข) โดยการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นนั้น สามารถวัดได้จาก การทดสอบและเป็นอัตราส่วนโดยตรงกับสภาพยอม



รูปที่ 2.4 ความต่างไฟระหว่างกระแสลับ (I) และศักยไฟฟ้า (V) ของ (ก) โลหะอิเล็กทริก (ก) กรณีไม่มีการสูญเสียพลังงาน (ข) กรณีมีการสูญเสียพลังงาน

ในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกการสลับทิศทางของไฟเพลตามความถี่ของแหล่งกำเนิดได้ความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าเรซซันและสนามไฟฟ้า (Polarization versus field) ซึ่งความสัมพันธ์จะพบในภาพของวงรอบไฮสเตอรีซิส (Hysteresis loop) ดังภาพ 5 เมื่อให้สนามไฟฟ้าเข้าไปครั้งแรกการเกิดไฟฟ้าเรซซันเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งถึงจุดอิมตัว (saturation polarization) คือ จุด b ซึ่งการเกิดไฟฟ้าเรซซันมีค่ามากที่สุด ได้ไฟฟ้าทั้งหมดจะเรียงตัวบนกัน และหากเพิ่มสนามไฟฟ้าไปมากกว่านั้น ก็ไม่มีผลต่อการเกิดไฟฟ้าเรซซัน เมื่อสนามไฟฟ้ามีค่าลดลงแทนที่การไฟฟ้าเรซซันจะถอยกลับไปตามเส้นทางเดิม เมื่อถอนตอนเริ่มต้น ($P = 0$) แต่กลับไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกัน เมื่อว่าไม่มีการให้สนามไฟฟ้า ($E = 0$) แก้วัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกก็ตาม แต่ยังคงมีไฟฟ้าเรซซันหลงเหลืออยู่ หรือรีเมานท์ ไฟฟ้าเรซซัน (remanent value: P_r) ที่จุด C ถ้าเราต้องการทำจุดไฟฟ้าเรซซันที่ยังหลงเหลืออยู่ เราต้องให้สนามไฟฟ้าย้อนกลับทิศทางเดิม (บวกคือ $-E$) ไฟฟ้าเรซซันจะลดลงสู่ศูนย์ที่จุด d ซึ่งเรียกจุดนี้ว่าสนามโคเออร์ซีฟ (coercive field: E_c) ถ้าเรายพยายามให้สนามไฟฟ้าในทิศทางลงนี้สูงขึ้นอีก ในที่สุดก็จะถึงจุดอิมตัว ที่จุด C ข้ามไฟฟ้าทั้งหมดชี้ไปทางขวา เมื่อถึงจุดอนนี้ ถ้าไม่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับวัสดุเฟอร์โร อิเล็กทริก แล้วปล่อยให้วัสดุที่มีไฟฟ้าเรซซันจะกลับสู่ศูนย์ที่จุด g และในที่สุดก็จะมุ่งไปสู่จุดอิมตัวที่จุด b



รูปที่ 2.5 วงรอบอิสเทอร์ซิสระห่วงโพราไรเซชันกับสนามไฟฟ้าในสารเฟรโรอิเล็กทริก

2.1.4 สมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric property) [8-9]

วัสดุไดอิเล็กทริก เป็นชนิดหนึ่งของอนุวัติที่ไม่นำไฟฟ้า และยังสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้อีกด้วย ซึ่งค่าความสามารถในการกักเก็บประจุไฟฟ้าของสารไดอิเล็กทริก เรียกว่า ค่าความจุไฟฟ้า (capacitance) เมื่อใส่สนามไฟฟ้าแก่สารไดอิเล็กทริก สารไดอิเล็กทริกจะเกิด polarization ขึ้นซึ่งเท่ากับค่าผลรวมของโพลาไรเซชันต่อหน่วยปริมาตร (net polarization/unit volume) ซึ่งถ้าค่า polarization สูงก็จะส่งผลให้สารไดอิเล็กทริกมีค่า capacitance สูงตามไปด้วย โดยสมบัติทางไดอิเล็กทริกมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ตัว คือค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (relative permittivity: ϵ_r) ความคงทนไดอิเล็กทริก (dielectric strength) และค่าสูญเสียไดอิเล็กทริก (dielectric loss) ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (Relative permittivity)

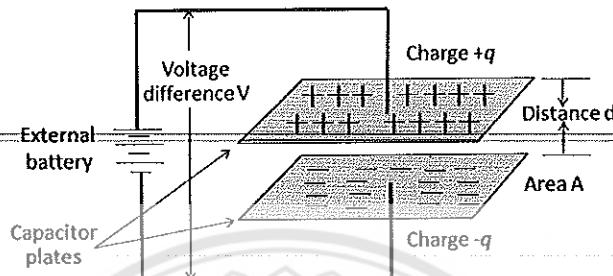
พิจารณาตัวเก็บประจุอย่างง่ายคือ แผ่นหนานที่ทำด้วยโลหะโดยวางห่างกันด้วยระยะ d พื้นที่ของแผ่นเท่ากับ A ดังแสดงในรูปที่ 6 ระหว่างแผ่นหนานเป็นสูญญากาศ เมื่อมีศักย์ไฟฟ้า V คร่อมแผ่นหนานโดยที่แผ่นโลหะแผ่นประจุ $+Q$ และอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นประจุ $-Q$ ค่าประจุนี้จะเป็นสัดส่วนกับ V ดังสมการ (7)

$$Q = CV \quad (7)$$

หรือ

$$C = \frac{Q}{V}$$

เมื่อ C คือ (capacitance) มีหน่วยเป็น คูลومบ์ต่อโวลต์ (C/V) หรือ พาร์ด (F)



รูปที่ 2.6 แสดงตัวเก็บประจุแผ่นขนาด

ความจุไฟฟ้าบวกถึงความสามารถในการกักเก็บประจุ ยิ่งมีความจุไฟฟ้ามากเท่าใดยิ่งเก็บประจุได้มากเท่านั้น ถ้าหากตัวเก็บประจุมีขนาดพื้นที่ขนาดมากกว่าระยะห่างระหว่างแผ่นขนาดมากๆ จะได้ว่า ความจุไฟฟ้ามีค่าดังสมการ (8)

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (8)$$

ϵ_0 คือ ค่าคงที่โดยอิเล็กทริกค่าส่วนพิเศษ (permittivity) ในสุญญากาศ มีค่า 8.854×10^{-12} พาร์ดต่อเมตร (F/m)

A คือ พื้นที่ของไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m^2)

C คือ ค่าความจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นพาร์ด (F)

d คือ ความหนาของสารไดอิเล็กทริก มีหน่วยเป็นเมตร (m)

ในกรณีที่มีสารไดอิเล็กทริกอยู่ระหว่างแผ่นขนาด ความจุไฟฟ้าจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าซึ่งเท่ากับค่าส่วนพิเศษ (relative permittivity) หรือที่เรียกว่าค่าคงที่โดยอิเล็กทริก (dielectric constant) ของเซรามิก ดังสมการ 9

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} \quad (9)$$

เมื่อ ϵ_r คือ ค่าส่วนพิเศษ (Permittivity) ในสุญญากาศ โดยมีค่าประมาณ 8.854×10^{-12} พาร์ดต่อเมตร F/m

การมีสารไดอิเล็กทริกอยู่ในตัวเก็บประจุจะช่วยเพิ่มพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุให้สามารถสร้างตัวเก็บประจุขนาดเล็กแต่ความจุไฟฟ้าสูงได้ ความคงทนไดอิเล็กทริก (Dielectric strength) ความคงทนไดอิเล็กทริก เป็นสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งในการประเมินคุณภาพของไดอิเล็กทริกเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงความทนทานต่อความต่างศักย์ของไดอิเล็กทริก ความคงทนได อิเล็กทริกมีค่าเท่ากับศักย์ไฟฟ้าสูงสุดที่ได

เล็กทริกยังคงใช้งานได้ โดยปราศจากความเสียหายต่อความยาวหนึ่งหน่วย ถ้าวัสดุได้อิเล็กทริกถูกป้อนด้วยค่าความค่าศักย์ที่สูงมากๆ อาจจะทำให้แฟกเตอร์สูญเสียพลังงาน (Energy loss factor) ถ้าป้อนความค่าศักย์ไฟฟ้าให้แก่สารได้อิเล็กทริกที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานเลย ศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบชายน์แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าศักย์ไฟฟ้าซึ่งมีรูปคลื่นแบบชายน์แบบเดียวกับไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะนำหน้าศักย์ไฟฟ้าอยู่ 90 องศา แต่ในความเป็นจริงนั้น สำหรับไดอิเล็กทริกที่ว่าไป มุมต่างเฟสจะน้อยกว่า 90 องศา เสมอ ถ้าให้ δ คือค่ามุนที่นำไปลบออกจาก 90 องศา ปริมาณ $\tan \delta$ จะหมายถึง แฟกเตอร์สูญเสียพลังงานในไดอิเล็กทริกของตัวเก็บประจุเมื่อใช้งานกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2.1.5 การซินเตอร์

การซินเตอร์ (sintering) คือการบวนการทำงานร้อนที่ทำใหอนุภาคเกิดการสร้างพันธะกันอย่างสมดุล โดยมีโครงสร้างหลักเป็นของแข็งที่พัฒนามาจากการเคลื่อนย้ายมวลลักษณะต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในระดับของอะตอม การเกิดพันธะเชื่อมต่อ กันดังกล่าวทำให้ระบบมีความแข็งแรงสูงขึ้นและมีพลังงานลดลง นอกจากนี้ยังอาจก่อตัวได้ว่าการซินเตอร์นั้นหมายถึงการกำจัดรูพรุนที่อยู่ระหว่างอนุภาค ผงเริมต้น โดยอาศัยการหดตัวขององค์ประกอบที่เขื่อมอยู่ติดกันแล้วเกิดการเดิบโตไปด้วยกัน โดยมีการสร้างพันธะที่แข็งแรงระหว่างอนุภาคที่อยู่ติดกันขึ้นมาทุกขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนสภาพขั้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป ไปเป็นโครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยการยึดเกาะกันของเกรนต่างๆ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการซินเตอร์ทั้งสิ้น แรงขับดันสำหรับการซินเตอร์นั้นได้มาจาก การลดพื้นที่ผิวและพลังงานของพื้นผิวด้วยการใช้ของแข็งที่เขื่อมยึดกันโดยมีพลังงานของเกรนแบบแข็ง-ของแข็ง (γ_{c}) ที่ค่อนข้างต่ำเข้าไปแทนที่กลุ่มอนุภาคผงที่ยึดกันอยู่อย่างหลวมๆ ซึ่งจะมีพลังงานพื้นผิวแบบของแข็ง-ไอ (γ_{sv}) ที่สูงมากด้วยเหตุนี้ของการผลิตเซรามิกส่วนใหญ่จึงนิยมเลือกใช้ออนุภาคผงตั้งตันที่มีขนาดอนุภาคเล็กเนื่องจากอนุภาคผงที่มีขนาดยิ่งเล็กเท่าไรก็จะยิ่งมีพื้นที่ผิวมากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ระบบมีแรงขับดันสำหรับการซินเตอร์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้ขั้นงานสามารถเกิดการแผ่นตัวได้ จึงมีความหนาแน่นสูง หรือทำให้สามารถใช้อุณหภูมิในการเผาที่ต่ำลงได้ [10]

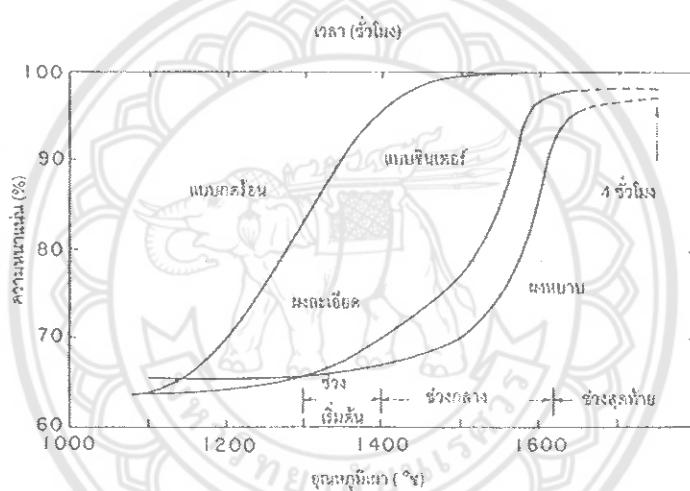
การหดตัวของชิ้นงานเซรามิกขณะที่ทำการซินเตอร์สามารถตรวจสอบได้จากการวัดขนาดหรือหาก่าความหนาแน่นของชิ้นงานขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และเวลาในการเผา ดังเช่น ตัวอย่างของพฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็ง (solid - state sintering) ที่ว่า ๆ ไป ที่แสดงดังรูปที่ 2.8 ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นตอนหลักที่มีความคาดการณ์ไว้ต่อเนื่องกันอยู่คือ

1. การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (initial sintering) จะเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวกันในแนวอิทธิพลรังนึงของอนุภาคผงภายในชิ้นงานและการเกิดพันธะที่แข็งแรง หรือคอ (neck) ขึ้นมาที่บริเวณจุดสัมผัสระหว่างอนุภาคผง ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานในช่วงนี้อาจจะเพิ่มขึ้นจาก 0.5 ไปถึง 0.6 ได้ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการที่อนุภาคผงมีการแพคตัวกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รูปที่ 2.8 (x)

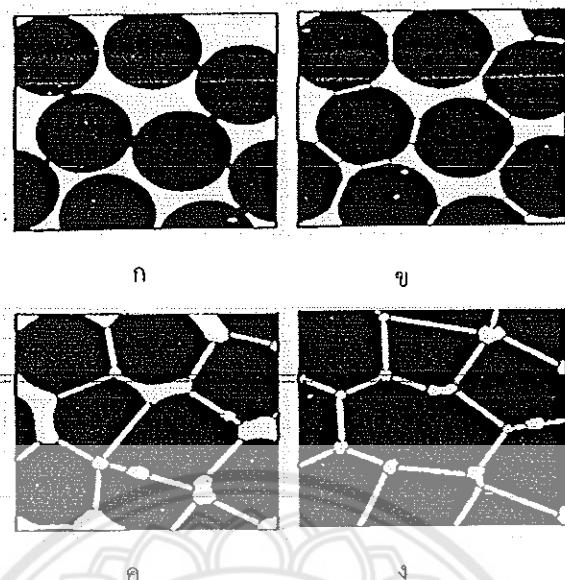
2. การซินเตอร์ช่วงกลาง (intermediate sintering) เป็นช่วงที่ขนาดของคอเริ่มโตขึ้นและปริมาณของความพรุนในชิ้นงานจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอนุภาคเริ่มเข้ามาใกล้ชิดติดกันมากยิ่งขึ้น ทำ

ให้ชิ้นงานเกิดมีการหดตัวลงอย่างชัดเจน เริ่มมีเกรนและขอบเกรนเกิดขึ้นพร้อมกับมีการเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้ ทำให้เกิดมีการเติบโตของเกรนบางเกรนขึ้น ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องในขณะที่ซ่องว่างของรูพุนจะเริ่มเกิดการเชื่อมต่อกัน (พวกรูพุนเปิด) และจะสิ้นสุดพฤติกรรมนี้ในทันทีเมื่อรูพุนเกิดมีการแยกตัวหลุดออกไปอยู่ต่างหาก (พวกรูพุนปิด) การหดตัวของชิ้นงานจะเกิดขึ้นมากที่สุดในการซินเตอร์ช่วงกลางนี้ และอาจจะทำให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชิ้นงานมีค่าสูงถึงประมาณ

3. การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย (final stage sintering) เป็นช่วงที่รูพุนในชิ้นงานเริ่มปิดตัวลงและค่อยๆ ถูกถ่วงจัดให้หมดไปจากชิ้นงานอย่างช้าๆ โดยอาศัยกลไกการแพร์ของอากาศจากรูพุนอุณหภูมิตามแนวของขอบเกรน และหลุดออกไปจากผิวของชิ้นงาน ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานเกิดการแปรรูปเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกเพียงเล็กน้อย ขนาดของเกรนจะเพิ่มขึ้นในการซินเตอร์ช่วงสุดท้ายนี้ รูปที่ 2.8 (๑)



รูปที่ 2.7 แสดงพฤติกรรมการซินเตอร์แบบสถานะของแข็งทั่วๆ ไปในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการเผา



รูปที่ 2.8 แสดงพัฒนาการของโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการซินเตอร์แบบสถานะของเหลว (ก)
อนุภาคผงยึดกันอยู่แบบหลวมๆ หลังการอัดขึ้นรูป (ข) การซินเตอร์ช่วงเริ่มต้น (ค) การซิน
เตอร์ช่วงกลางและ (ง) การซินเตอร์ช่วงสุดท้าย

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว

การซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลว (liquid phase sintering) เป็นกระบวนการเผาซินเตอร์ที่มีองค์ประกอบหนึ่งของวัสดุเกิดการหลอมเหลวขึ้นจนกลایสภาพไปเป็นของเหลวในระหว่างที่มีการซินเตอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่นิยมใช้ในการผลิตเซรามิกด้วยการใช้อุณหภูมิเผาซินเตอร์ที่ต่ำลงเนื่องจากโดยปกติแล้ววัสดุพากเซรามิกส่วนใหญ่จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงมากบางชนิดอาจสูงถึงประมาณ 300 องศาเซลเซียส ทำให้ต้องมีการใช้พลังงานที่สูงมากในการเผาซินเตอร์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้และมีเวลาไฟอยู่ไม่กี่ประเภทที่สามารถใช้งานภายใต้เงื่อนไขนี้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารในภาชนะที่หลอมตัวกับภาชนะเองได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเทคนิคการผลิตเซรามิกเหล่านี้ที่อุณหภูมิต่ำลงด้วยการใช้สารช่วยหลอมหรือฟลักซ์ (fluxes) ซึ่งเป็นอนุภาคผงที่เติมลงไปเพื่อทำหน้าที่ช่วยให้ขั้นงานเกิดการหลอมเหลวที่ต่ำกว่าสารอองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์มาก จึงเกิดเป็นเฟสที่เป็นของเหลวให้เคลื่อนย้ายที่ในระหว่างการซินเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กระบวนการซินเตอร์แบบมีเฟสของเหลวมีอยู่สองระบบคือ

- ระบบที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อขั้นงานได้รับความร้อนจนกระหึ่งถึงอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นและคงสภาพอยู่ตลอดช่วงของการซินเตอร์และเมื่อขั้นงานเริ่ม เป็นตัวลงเฟสที่เป็นของเหลวนี้จะเกิดการแข็งตัวแยกเฟสอยู่ในขั้นงาน

2. ระบบที่มีความเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อขึ้นงานได้รับความร้อนจนกระทั่งถึงอุณหภูมิของการซินเตอร์จะมีเฟสที่เป็นของเหลวเกิดขึ้นแล้วค่อย ๆ หายไปช้า ๆ ด้วยการละลายลงไปอยู่ในเมทริกซ์ของขึ้นงาน

กระบวนการซินเตอร์ที่มีเฟสของเหลวประกอบด้วย 4 ระยะหลักดังนี้

1. ระยะที่อนุภาคมีการจัดเรียงตัวกันใหม่ (particle rearrangement stage) หลังจากที่มีการหลอมเหลวเกิดขึ้นอนุภาคของแข็งจะถูกแรงดันรูดเล็กจากของเหลวดึงเข้าการกัน ทำให้ขึ้นงานเกิดมีการหดตัวอย่างรวดเร็ว และมีการกำจัดรูปทรงออกไปจากขึ้นงาน

2. ระยะที่อนุภาคมีการแยกออกจากกันแล้วเกิดการตกตะกอนข้า (dissolution reprecipitation stage) มีหลายกรณีที่อนุภาคของแข็งสามารถละลายในเฟสที่เป็นของเหลวได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งความโคลงของอนุภาคของแข็งและความดัน ณ จุดสัมผัสระหว่างอนุภาคของแข็งจะช่วยทำให้เกิดมีการแยกออกจากกันของอนุภาคได้ เมื่อเกิดมีการละลายขึ้น ตัวถูกละลายจะแพร่เข้าสู่จุดที่มีความคงดองกันข้ามภายในโครงสร้างจุลภาค และเกิดการตกตะกอนจนทำให้เกรนบริเวณดังกล่าวมีขนาดโตขึ้นซึ่งตัวที่ตกตะกอนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเดียวกันกับอนุภาคของแข็งเริ่มต้นก็ได้แต่อาจจะเป็นตัวใหม่ที่มีองค์ประกอบของหั้งที่ได้จากเฟสที่เป็นของแข็งและที่เป็นของเหลวอยู่ร่วมกัน ซึ่งการตกตะกอนในลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้ปริมาณเฟสของเหลวที่เกิดขึ้นในระบบลดลงขณะที่มีการตกตะกอน

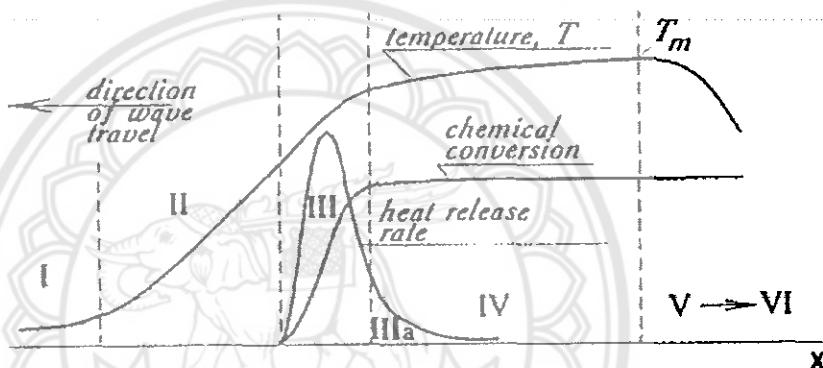
3. ระยะที่ของเหลวมีการสماนาลักษณ์ (liquid assimilation) ในบางกรณีของเหลวจะเข้าไปประปนอยู่ร่วมกับเฟสที่เป็นของแข็งได้โดยตรงด้วยการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีหรืออาจจะเข้าไปแทรกอยู่ด้วยแรงกล จนทำให้เกิดการเป็นของแข็งที่อยู่ในรูปของสารละลายของแข็งที่เกิดจากการถูกดูดซับของเหลวหรือเกิดเฟสใหม่ที่ตกลงมาจากสารที่เกิดการหลอม

4. ระยะที่มีการเติบโตของเกรนในสถานะของแข็ง (solid state grain growth stage) เมื่อของเหลวถูกรีดออกมากจากอนุภาคที่อัดกันแน่น หรือมีการแพร่เชื้อเข้าไปอยู่ภายในของแข็งจะทำให้เกิดมีขอบเกรนปรากฏขึ้นมา ซึ่งถ้าหากระบบยังมีการซินเตอร์อยู่ก็จะมีผลต่อกรรมการเติบโตของเกรนเป็นขั้นตอนหลักที่อยุคคุณพุตติกรรมของการซินเตอร์ต่อไป

2.1.6 เทคนิคการเผาไหม้ [11]

การเตรียมผงผลึกด้วยวิธีการการเผาไหม้ เป็นการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติอย่างพัฒนา ความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีในขั้นตอนการผลิต มีการใช้กันมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อ Beketov และ Goldshmidt ได้ค้นพบ self-sustaining thermite reaction ซึ่งต่อมามาได้ใช้หลักการจุดระเบิดของปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการผลิตอย่างมากมาย เช่น ในกระบวนการผลิตเทาหลอมเหล็ก การผลิตเพอร์โรลลอลอย ฯลฯ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทฤษฎีการเผาไหม้ (combustion) ยุคใหม่ไม่ได้มีรูปแบบอย่างที่เคยปฏิบัติตาม (ในปี ค.ศ.1930-1940 สำหรับแก๊ส และปี ค.ศ.1950-1960 สำหรับของเหลว) ในปี ค.ศ.1967 ได้มีการค้นพบปราภากฎการณ์จุดระเบิดของแข็ง ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะได้ผลผลิตใน

สถานะของแข็ง และการพัฒนาวิธีการเผาไหม้บนพื้นฐานของ self-propagation high-temperature (SHS) ได้กระตุ้นให้เกิดการทดลองและการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผาไหม้ของสารประกอบอนินทรีย์และวัสดุอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้กล่าวเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการเผาไหม้และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกระบวนการเผาไหม้มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง สำหรับวัสดุชั้นสูงและกระบวนการผลิตเพื่อการประหยัดพลังงาน ในปัจจุบันการควบคุมความเร็วของการจุดระเบิด อุณหภูมิ สัดส่วน และโครงสร้างของผลผลิตทำได้โดยการประยุกต์แนวคิดแผนใหม่ของทฤษฎีคณรเเผไหม้และโครงสร้างจลนพลดศาสตร์ทั่วภาค ของปฏิกริยาเคมี ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการทั่วไปของการเผาไหม้ ได้ดังรูป 9



รูปที่ 2.9 แสดงการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเผาไหม้

ช่วงที่หนึ่ง เป็นช่วงเริ่มต้นของปฏิกริยา ช่วงที่สอง เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดปฏิกริยา ซึ่งช่วงนี้จะยังไม่มีปฏิกริยาเกิดขึ้น แต่จะมีการถ่ายเทความร้อนเพิ่มมากขึ้น ช่วงที่สาม เป็นช่วงที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างของวัสดุ โดยจะมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมามีการจุดระเบิด และความร้อนที่ปลดปล่อยออกมานี้จะแพร่ไปสู่ช่วงต้นของช่วงที่สี่ คือ ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical conversion) ส่วนที่กวางที่สุดของช่วงนี้ คือ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงเฟสและโครงสร้างของวัสดุ ซึ่งขึ้นตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดโครงสร้างสุดท้ายและมีบทบาทสำคัญต่อสมบัติของวัสดุ ในช่วงที่ห้าของกระบวนการ เป็นช่วงที่วัสดุเกิดการเย็นตัว และในช่วงนี้อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างของวัสดุ ถ้าการเย็นตัวเกิดขึ้นอย่างช้าๆจะทำให้โครงสร้างของวัสดุที่สมดุล ดังนั้นในกระบวนการเผาไหม้ อัตราการให้ความร้อนจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของการปลดปล่อยความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ส่วนคุณลักษณะของวัสดุที่ได้จะขึ้นอยู่กับเฟส โครงสร้าง เนื้องอก และอัตราการเย็นตัวของวัสดุ

2.1.7 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-Ray Diffractometer) [12]

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สัดพื้นฐานแบบไม่ทำลาย (Non-destructive analysis) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมในโมเลกุลของสารประกอบต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอกซ์และความรู้เกี่ยวกับวิชาระบบโครงสร้างผลึก

รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอำนาจการทะลุทะลวงสูง มีความยาวคลื่นสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 – 100 อั้งสตรอม การเกิดอันตรภิริยาของรังสีเอกซ์กับสารนั้นก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวล้วนเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด ซึ่งหลักการดังกล่าวเหล่านี้เราจึงสามารถนำมายใช้วิเคราะห์สารได้ดังนี้

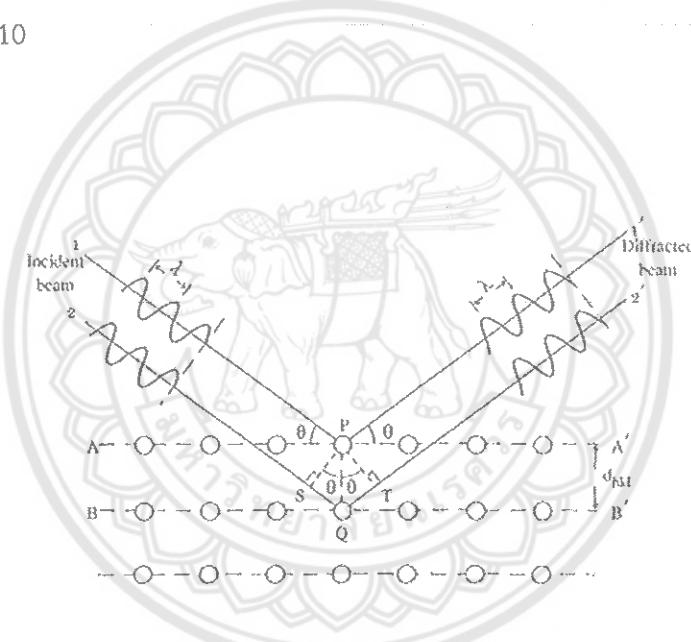
1. ใช้วิเคราะห์ทางคุณภาพของธาตุต่าง ๆ ในสารทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ใช้ศึกษาหาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
3. ใช้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างผลึก หรือโมเลกุลของสารด้วยการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์มีทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติจากการถล่มตัวของนิวเคลียสรากทุกมันตั้งสีและที่มนุษย์ผลิตขึ้นจากกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่ออัตโนมัติรับการกระตุนด้วยอิเล็กทรอนที่มีพลังงานสูง วิ่งชนอะตอม ทำให้เกิดอันตรภิริยา ระดับพลังงานของอิเล็กทรอนขึ้นกว่าครึ่งตัว ๆ ของอะตอมมีค่าสูงขึ้น เกิดภาวะเข้าสู่ปกติ โดยมีเวลาของอะตอมไม่เปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นกระบวนการการปลดปล่อย พลังงานส่วนเกิน ในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไฟฟ่อนอกมาในลักษณะพัลส์ (pulse) จากอะตอมทุกครั้ง ที่ได้รับการกระตุน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมานี้เรียกว่า “รังสีเอกซ์” ซึ่งแบ่งได้ 2 ชนิด ตามกระบวนการของการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินจากอะตอมบริเวณชั้นโคจรอิเล็กทรอน คือ

(1) รังสีเอกซ์เฉพาะตัว มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานเดียว (monochromatic X-ray) เพราะเกิดจากการลดระดับพลังงานที่แน่นอน ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่ออิเล็กทรอนหรืออนุภาคที่มีประจุบวกอื่น ๆ หรือไฟฟ่อนพลังงานสูงเคลื่อนที่เข้าชนอิเล็กทรอนในวงโคจรชั้นในของอะตอม แล้วถ่ายโอนพลังงานให้อิเล็กทรอน อิเล็กทรอนชั้นในวงโคจรได้รับพลังงานเพิ่มสูงขึ้น กว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของชั้นวงโคจร ทำให้หลุดจากวงโคจรเกิดที่ว่างของอิเล็กทรอนในชั้นวงโคจรชั้นใน ให้อัตโนมัอยู่ในภาวะที่ถูกกระตุนและจะลดระดับพลังงานลงสู่ภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอันสั้น โดยอิเล็กทรอนของวงโคจรในชั้นถัดไปจะลดระดับพลังงานลงมาให้เท่ากับพลังงานยึดเหนี่ยวของวงโคจรชั้นใน ด้วยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมานี้ในรูปรังสีเอกซ์ แล้วเข้ามาแทนที่ช่องว่างของวงโคจรชั้นใน พลังงานส่วนเกินนี้จะมีค่าเท่ากับความต่างระดับพลังงานยึดเหนี่ยวเฉพาะวงโคจรของอิเล็กทรอน และชนิดของธาตุนั้น ๆ จึงมีพลังงานเฉพาะค่า

(2) รังสีแบบต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานต่อเนื่องกระจายจากค่าต่ำสุดถึงสูงสุด ปรากฏการณ์ของการเกิดรังสีเอกซ์ต่อเนื่องเกิดจากอิเล็กทรอนพลังงานสูงเคลื่อนเข้าสู่สนามคูลอมบ์ (coulomb field) บริเวณใกล้นิวเคลียส ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าสถิตย์บริเวณดังกล่าวทำให้อิเล็กทรอนสูญเสียพลังงานอย่างรวดเร็วและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมายก่อนที่อิเล็กทรอนปัจจุบันจะทำอันตร

กิริยา กับ สนามไฟฟ้า บริเวณ ใกล้ นิวเคลียส ที่เกิดจาก ประจุ ของ อะตอม อิเล็กตรอน จะ สูญเสีย พลังงาน บางส่วน อันเนื่องจากการกระเจิง ของ อิเล็กตรอน ดังนั้น พลังงาน ของ รังสี เออกซ์ ที่ เกิดขึ้น จะ มีค่า กระจาด ต่อเนื่อง จาก พลังงาน ต่ำ สุด ถึง สูง สุด ของ อิเล็กตรอน ปัจจุบัน ถ้า อิเล็กตรอน ปัจจุบัน มี พลังงาน สูง พอ ที่ จะ กระตุ้น ให้ อิเล็กตรอน ใน วง โคจร ชั้น ใน ของ อะตอม หลุด ออก ได้ ก็ จะ เกิด รังสี เออกซ์ เฉพาะ ค่า ปะปน ช้อน อยู่ กับ สเปกตรัม ของ รังสี เออกซ์ ที่ อ่อน กว่า ตาม ด้วย เสมอ การ ปลดปล่อย รังสี เออกซ์ ออก มา ที่ ความ ยาวคลื่น ใด ๆ ขึ้น อยู่ กับ ระดับ พลังงาน ที่ คาย ออก มา ซึ่ง ความ ยาวคลื่น ที่ สั้น ที่ สุด เกิด จากการ ที่ อิเล็กตรอน คาย พลังงาน ที่ ได้ รับ มา หัก หมุด จาก แหล่ง กำเนิด โดย ไม่ เข้า กับ ชนิด ของ เป้าหมาย ที่ ใช้ เมื่อ รังสี เออกซ์ ตก กระทบ ผิว หน้า ของ แผ่น โดย ทำ หมุน θ บาง ส่วน ของ รังสี เออกซ์ จะ เกิด การ กระเจิง ด้วย ชั้น ของ อะตอม ที่ ผิว หน้า อีก ส่วน หนึ่ง ของ ลำ รังสี เออกซ์ จะ ผ่าน ไป ยัง ชั้น ที่ 2 ของ อะตอม ซึ่ง บาง ส่วน จะ กระเจิง และ ส่วน ที่ เหลือ ก็ จะ ผ่าน เข้า ไป ยัง ชั้น ที่ 3 ของ อะตอม ดัง รูป ที่ 10



รูปที่ 2.10 แบบจำลองสำหรับการพิสูจน์กฎของเบรคก์

ถ้า อะตอม ใน แผ่น ก็ มี การ จัด เรียง ตัวอย่าง ไม่ เป็น ระเบียบ และ มี ระยะห่าง ระหว่าง อะตอม ที่ 2 ๆ กัน ลำ รังสี เออกซ์ ที่ ผ่าน เข้า ไป ใน แต่ละ ชั้น ของ อะตอม จะ เกิด การ เลี้ยว บน เป็น ลำ ขนาด กัน สิ่ง สำคัญ ใน การ เกิด การ เลี้ยว บน ของ รังสี เออกซ์ ชั้น อยู่ กับ ภาระ 2 ประการ คือ

1. รังสี ที่ ตก กระทบ รังสี เลี้ยว บน และ เส้น ตั้ง ฉาก กับ ผิว หน้า จะ ต้อง อยู่ ใน ระนาบเดียวกัน
2. ระยะห่าง ระหว่าง ชั้น ของ อะตอม ควร มี ค่า ใกล้ เคียง กับ ความ ยาวคลื่น ของ รังสี เออกซ์

เมื่อ ปี ค.ศ. 1912 แบรคก์ ได้ ยิง ลำ รังสี เออกซ์ แคบ ๆ กระทบ ผิว หน้า แผ่น ให้ เป็น หมุน Θ เพื่อ ให้ เกิด การ เลี้ยว บน และ การ กระเจิง เมื่อ เกิด อัน ตร กิริยา กับ อะตอม O, P และ R ถ้า

$$SQ + QT = n\lambda \quad (10)$$

เมื่อ n คือ จำนวนเต็ม รังสีที่กระเจิงจะอยู่ในไฟฟ้าที่ OCD ผลึกจะทำหน้าที่สะท้อนรังสีเอกสารจะเห็นว่า

$$SQ = QT = d \sin \theta \quad (11)$$

เมื่อ d คือ ระยะห่างระหว่างชั้นของผลึก เขียนสนการใหม่ได้ว่า

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (12)$$

เรียกสมการนี้ว่า สมการของแบร์ก (Bragg's equation) ซึ่งมีประโยชน์มาก สำหรับการศึกษาที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ เช่น สารที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเดียว (single crystal) และผลึกเชิงซ้อน (polycrystalline)- เพราะในสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบกรรเรียงตัวของอะตอมเป็นลักษณะเฉพาะ เมื่อเราทราบถึงค่ามุมที่เกิดการเลี้ยงเบนไปของรังสีเอกสารเมื่อชนกับอะตอมของสาร เราจะทราบถึงระยะห่างระหว่างแต่ละอะตอมของสารนั้น ๆ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์หาชนิดของสาร (qualitative analysis) รวมไปถึงสมบัติทางกายภาพของสารนั้น ๆ อีกด้วย

การคำนวณหาค่าคงที่ a , b และค่าอัตราส่วน c/a สามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลจากเครื่องเอกซเรย์ดิฟเฟรนซ์ และจากสมการที่ (13)

$$\frac{1}{d} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2 + b^2 + c^2} \quad (13)$$

ในระบบคิวบิกนั้น ค่าคงที่ a มีค่าเท่ากับและคงที่ b และ c จากสมการที่ (13) เขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2} \quad (14)$$

2.1.8 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) [13]

เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบทั้งแบบใช้แสงธรรมชาดและใช้รังสีแบบอื่น ๆ มีข้อจำกัดในการขยายภาพ เพราะกำลังขยายและกำลังแยกออกจากจะชั้นกับลักษณะของเลนส์แล้ว ยังขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นของแสงที่ใช้อีกด้วย กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบสามารถมีกำลังแยกขณะส่องดูวัตถุขนาดเล็กสุดได้เพียง 0.2 ไมโครเมตรเท่านั้น ส่วนกำลังขยายรวมก็ไม่เกิน $2,000$ เท่า จึงยังมองเห็นวัตถุภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กเป็นจุด ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ร่ว่าส่วนนั้นเป็นอะไร ต่อมาได้มีการนำเอาอิเล็กตรอนซึ่งมีช่วงคลื่นสั้นกว่าคลื่นของแสงมาก เข้ามาใช้ในกล้องจุลทรรศน์แทนคลื่นแสง และใช้เลนส์แม่เหล็กแทนเลนส์ประกอบ เรียกกล้องดังกล่าวว่า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นกล้องที่ใช้ศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบพื้นผิวของเซลล์เนื้อเยื่อและวัตถุได้ โดยทำให่องค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์หรือวัตถุให้มีความเข้มข้นเจ้าแตกต่างกัน

หลักการเกิดภาพของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

อิเล็กตรอนปฐมภูมิ (primary electron) จากแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน (electron gun) จะถูกเร่งด้วยศักยไฟฟ้าสูง ($1,000$ ถึง $3,000$ อิเล็กตรอนโวลท์ หรือมากกว่า) ที่สามารถปรับค่าได้ จากนั้นจึงถูกดึงดูดลงสู่เบื้องล่างโดยแผ่นอาโนด (anode plate) ภายใต้ภาวะความดันสูญญากาศ 10^{-5}

- 10^{-7} ทอร์ และมีชุดคอนเดนเซอร์เลนส์ที่จะปรับลำอิเล็กตรอน (electron beam) ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มของลำอิเล็กตรอน จากนั้นลำอิเล็กตรอนจะวิงลงสู่เบื้องล่างผ่านเคนส์วัตถุ ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิให้มีจุดโฟกัสบนผิวตัวอย่างพอดี และลำอิเล็กตรอนที่ตกกระทบผิวตัวอย่างหรือตัวอย่างจะมีขนาดในช่วง 5 ถึง 200 นาโนเมตร โดยมีชุดขดลวดควบคุมการส่องกราด (scan coil) ของลำอิเล็กตรอนทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของลำอิเล็กตรอนบนผิwtัวอย่าง ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดได้โดยผ่านทางชุดควบคุม (control unit) ขณะที่ลำอิเล็กตรอนกระแทบทิศทางที่ต้องการ กระตุ้นทรรศริยยา (interaction) ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกับตัวอย่างในตัวอย่างและเกิดการถ่ายโอนพลังงานที่ชั้นความลึกจากพื้นผิวที่ระดับต่างๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยสัญญาณอิเล็กตรอน (electron signal) ชนิดต่าง ๆ ออกมา ซึ่งใช้ประโยชน์ในการศึกษาลักษณะพิเศษของตัวอย่างและวิเคราะห์ธาตุที่มีในตัวอย่างได้ตามลักษณะสัญญาณภาพที่ได้จากสัญญาณอิเล็กตรอนชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น คือ

(1) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary Electron Image, SEI) หรือเป็นอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ 3-5 อิเล็กตรอนโวลต์ เกิดที่พื้นผิวระดับไม่ลึก (ไม่เกิน 10 นาโนเมตร) โดยเกิดกับชาตุที่มีแรงยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนที่ผิวต่างๆ

(2) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (Backscattered Electron Image, BEI) หรือเป็นกุ่มอิเล็กตรอนที่สูญเสียพลังงานให้กับอัตราในชั้นงานเพียงบางส่วนและกระเจิงกลับออกมานอกชั้นงาน ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เกิดที่พื้นผิวระดับลึกกว่า 10 นาโนเมตร โดยเกิดได้กับชาตุที่มีเลขอะตอมสูง

(3) สัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์ (X-Ray Image, XRI) ชนิดที่เป็นรังสีเอกซ์เฉพาะตัวเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอิเล็กตรอนในระดับชั้นโคจรต่าง ๆ (K, L, M,...) ถูกกระตุ้น (excited) หรือได้รับพลังงานมากพอจนหลุดออกจากวงโคจรออกมานอกชั้นงานเพียงบางส่วนและกระเจิงกลับออกมานอกชั้นงาน โดยการดึงอิเล็กตรอนจากชั้นวงโคจรถัดไปเข้ามาแทนที่และต้องลดพลังงานส่วนเกินออกมานอกชั้นงาน รูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทำให้ตัวเองมีพลังงานเท่ากับชั้นโคจรที่ไปแทนที่ ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความยาวคลื่นเฉพาะในแต่ละชาตุตามระดับพลังงานของตัวอย่างได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณภาพประกายบนจอรับภาพได้โดยต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการรับให้เหมาะสมกับสัญญาณแต่ละชนิด โดยทั่วไปสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิใช้ตัวตรวจวัดชนิดพลาสติกเรืองแสง (Plastic scintillation detector) สัญญาณภาพจากอิเล็กตรอนกระเจิงกลับจะใช้ตัวตรวจวัดที่เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดรอยต่อฟีอีน (PN junction detector) หรือตัวตรวจวัดชนิดโรบินสัน (Robinson detector) และในสัญญาณภาพจากรังสีเอกซ์จะใช้หัวรับรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำประเทกซิลิคอนลิตี้เทียม (lithium drifted silicon, Si (Li)) ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในการวิเคราะห์พลังงานของรังสีเอกซ์เฉพาะตัวซึ่งอุปกรณ์วิเคราะห์นั้นมีทั้งแบบซองเดียว (Single Channel Analyzer, SCA) และอุปกรณ์วิเคราะห์แบบหลายช่อง (Multi Channel Analyzer, MCA)

2.1.9 การหาความหนาแน่น (Density)

ความหนาแน่น หมายถึง ค่ามวลต่อปริมาตรของวัสดุ ณ อุณหภูมินี้ๆ หน่วยของค่าความหนาแน่นสามารถเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร ,กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ,ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต , กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นต้น สำหรับส่วนที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้จะใช้ในหน่วยของกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีความสำคัญทางด้านเชรามิกอย่างยิ่งคือ การอาศัยค่าความหนาแน่นเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการอัดแน่นตัวของวัสดุในระหว่างขั้นตอนการขึ้นรูป การหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานนั้นอาศัยหลักการของอาร์คิมิดส์ที่กล่าวไว้ว่า “เมื่อจุ่มของแข็งลงในของเหลวจะมีแรงพยุงเกิดขึ้นบนของแข็งนั้น โดยแรงพยุงที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของของแข็ง” วิธีการนี้ทำได้โดยการหาน้ำหนักของวัตถุในอากาศและขณะที่จุ่มอยู่ใน

$$\text{ความหนาแน่น } \rho = \frac{W_a}{W_a - W_{fl}} \cdot \rho_{fl} \quad (15)$$

เมื่อ ρ คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร

ρ_{fl} คือ ค่าความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

W_a คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัม

W_{fl} คือ น้ำหนักแห้งของชิ้นงานในของเหลว มีหน่วยเป็นกรัม

ส่วนการหาความหนาแน่นของของเหลวในการนี้ที่ทราบปริมาตรที่แน่นอนของของแข็งไปสามารถหาได้จาก

$$\rho_{fl} = G / V \quad (16)$$

โดยที่ G คือ แรงพยุงที่เกิดขึ้นกับของแข็ง หน่วยเป็นกรัม (หาได้จากน้ำหนัก

ของ) V คือ ชิ้นงานในอากาศลบด้วยน้ำหนักของชิ้นงานในของเหลว

V คือ ปริมาตรของของแข็งที่จุ่มลงในของเหลว มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร

สำหรับการหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density): ρ_r] นั้น สามารถคำนวณหาได้ตามสมการที่ (17)

$$\rho_r (\%) = \left(\frac{\rho_b}{\rho_{th}} \right) \times 100 \quad (17)$$

เมื่อ ρ_b คือ ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์

ρ_b คือ ค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ρ_{th} คือ ค่าความหนาแน่นในทฤษฎีของสาร มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 เนื่องไข่ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมเซรามิก ($Ba_{0.97}Ca_{0.03}(Ti_{0.94}Si_{0.06})O_3$) ให้ได้ประสิทธิภาพสูงโดยเทคนิคการเผาใหม่แบบสถานะของแข็ง [3]

เซรามิกไโพอิโซอิเล็กทริกที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์เซรามิกเป็นจำนวนมาก นานมากกว่าครึ่งศตวรรษเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ไโพอิโซอิเล็กทริกที่สูง ($d_{33} \geq 400 \text{ pC/N}$) และมีความเสถียรทางอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามการระหว่างของ PbO ที่เกิดขึ้นระหว่างการซินเทอร์ก่อให้เกิดผลพิษและอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ [14] ดังนั้น การประดิษฐ์เซรามิกไร์สารัตจะก้าวเพื่อนำมาใช้งานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

เซรามิกไโพอิโซอิเล็กทริกไร์สารัต ก้าวคุณภาพสูงสั่งเคราะห์โดยการเผาใหม่สถานะของแข็งและผลกระทบของเงื่อนไขการพัฒนาโครงสร้าง, โครงสร้างจุลภาค, ความหนาแน่น และตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ผงผลึก BCTS บริสุทธิ์ เกิดผลสำเร็จใช้การแคลไชน์ 1100 องศาเซลเซียส 4 ชั่วโมง เซรามิก BCTS ควบคุมโดยโครงสร้างเพอร์ฟไกท์ยืนยันโดยการวิเคราะห์ XRD การก่อเกิดเฟส โดยทั่วไปของเซรามิก BCTS แสดงเฟสร่วมของ $\text{O} + \text{T}$ เพสเททรโgnัลเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเทอร์ ยืนยันโดยโปรแกรมเรียหเวลด์ เซรามิก BCTS กับการพัฒนาที่ดีของลักษณะทางสัณฐาน-วิทยา, ความหนาแน่นสูง และสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี ($\epsilon_c = 19,185$, $P_r = 12.74 \mu\text{C/cm}^2$, $E_c = 1.60 \text{ kV/cm}$, และ $d_{33} = 528 \text{ pC/N}$ หลังได้รับการซินเทอร์ที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง ผลกระทบพัฒนาเพส, สัณฐานวิทยา, ความหนาแน่น และสมบัติทางไฟฟ้า ทั้งหมดสนับสนุนกันและกับการศึกษาเงื่อนไขสูงสุดในการผลิตไโพอิโซอิเล็กทริกเซรามิก BCTS ไร์สารัต ก้าว สำหรับการประยุกต์ใช้แทนที่วัสดุไโพอิโซอิเล็กที่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลัก

2.2.2 การเปลี่ยนเฟส โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกไโพอิโซอิเล็กทริก $\text{Ba}_{0.70}\text{Ca}_{0.30}\text{TiO}_3$ ปราศจากสารตะกั่ว ที่เติม Fe [15]

เพอร์ฟไกท์เป็นหนึ่งในวัสดุเพรโรอิเล็กทริกที่มีความสำคัญที่สุด BaTiO_3 (BT) และวัสดุที่มี BT เป็นองค์ประกอบหลักแสดงแนวโน้มไดอิเล็กทริก ไโพอิโซอิเล็กทริก ซึ่งได้รับความสนใจในการนำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น ตัวเก็บประจุแบบเซรามิกหอยลายชั้น (MLCC) ไโพอิโซอิเล็กทริก อุปกรณ์ทางแสง และสารกึ่งตัวนำ [16] ได้ถูกนำมาใช้กับงานวิจัยมากมาย ในบรรดาวัสดุที่มี BT เป็นองค์ประกอบหลัก $\text{BaTiO}_3\text{-xCaTiO}_3$ สารละลายของแข็งได้รับการยอมรับอย่างมาก ในสารละลาย BCTx การแทนที่ของ Ba^+ โดย Ca^+ เป็นสาเหตุให้อุณหภูมิคู่รีเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย แต่อุณหภูมิที่เปลี่ยนเฟสระหว่างเทหระโgnัล และօโรรอมบิกลดลงอย่างมาก นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของเพสเททรโgnัลและยังยั่งการก่อเกิดเฟสเอกซ์โgnัลของ BT

เซรามิกไโพอิโซอิเล็กทริกปราศจากตะกั่ว $\text{Ba}_{0.70}\text{Ca}_{0.30}\text{Ti}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ ($x = 0$ ถึง 0.3) ที่ได้เตรียม ผลของปริมาณ Fe ที่มีต่อโครงสร้างทางจุลภาค การเปลี่ยนเฟส ความหนาแน่น สมบัติทางไฟฟ้าได้รับการวิเคราะห์ เซรามิกที่เติม $x \leq 0.02$ แสดงเฟสร่วมของเทหระโgnัลและօโรรอมบิก เมื่อปริมาณเหล็กมากขึ้นจะไปยับยั่งการเกิดเฟสเทหระโgnอลและเพิ่มเพสคิวบิกเที่ยม ผลการเติม Fe ในปริมาณ $x = 0.03$ จะเกิดเฟสร่วมระหว่างօโรรอมบิกและคิวบิกเที่ยม เห็นได้ชัดว่าปริมาณขึ้นอยู่กับขนาดของเกรนที่สังเกตได้ จากที่กล่าวมา การเติม Fe ใน B ไซต์ ช่วยปรับปรุงความหนาแน่นและลดอุณหภูมิในการเผา

ชินเตอร์ ซึ่งสามารถกำหนดการแพร่ภายในอะตอมในระหว่างการชินเตอร์ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างออกไซเจนซึ่งกิดขึ้นโดยการแทนที่ของ Fe^{3+} ใน เมื่อ x เพิ่มขึ้นจาก 0 ถึง 0.03 ช่วยเพิ่มสมบัติให้อิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้อง ค่าการสูญเสียได้อิเล็กทริกลดลง และ T_c ลดลงจาก 128 เป็น 58 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามแสดงสมบัติเพื่อให้อิเล็กทริกที่สูงสุดที่ $x = 0.005$ และลดลงเมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้น



๑ ๖๐
๕๙๕
.๕
๕๙๔๖
๒๙๖๒

1039780



บทที่ ๓
วิธีดำเนินการวิจัย

๑๕ ๘๗ ๖๖๖

3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 แบบเรียมไนเตรต $Ba(NO_3)_2$	ความบริสุทธิ์ 99%
3.1.2 แคลเซียมไนเตรต $Ca(NO_3)_2 \cdot H_2O$	ความบริสุทธิ์ 99%
3.1.3 ไทเทเนียมไดออกไซด์ TiO_2	ความบริสุทธิ์ 99%-100.5%
3.1.4 ตินออกไซด์ SnO_2	ความบริสุทธิ์ 99.9%
3.1.5 เหล็ก Fe_2O_3	ความบริสุทธิ์ 97%
3.1.6 ไอลซิน $C_2H_5NO_2$	ความบริสุทธิ์ 98.5%
3.1.7 สารละลายเอทานอล (Ethanol absolution)	ความบริสุทธิ์ 99%
3.1.8 อะลูมิเนียมออกไซด์ Al_2O_3	ความบริสุทธิ์ 101.96 Mw%
3.1.9 โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ $(C_2H_4O)_n$	ความบริสุทธิ์ 98%-99%

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.2.1 เครื่องซั่งแบบละอียด Satorius AG GOTTINGEN type Fabr-Nr (ควบคุมการทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์) ใช้ชั่งมวลได้มากที่สุดไม่เกิน 220 กรัม โดยมีความละเอียด 0.001 กรัม

3.2.2 ตู้อบสาร ยี่ห้อ Memmert D06057 Model 100 อุณหภูมิในการอบสูงสุด 200 องศาเซลเซียส

3.2.3 กระป๋องพลาสติกที่ใช้ในการผสมสารทำด้วยโพลีเมอร์และมีฝาปิดสนิท โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ความสูง 10.7 เซนติเมตร

3.2.4 เม็ดบดย่อยทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร

3.2.5 เครื่องผสมสารเคมีที่ใช้บดย่อยแบบลูกบด (Ball milling)

3.2.6 Hot plate สำหรับใช้ในการทำให้สารระเหยออก

3.2.7 Magnetic stirrer สำหรับคนสารให้เข้ากัน

3.2.8 ข้อมตักสาร

3.2.9 บีกเกอร์ขนาด 250 ซีซี

3.2.10 บีกเกอร์ขนาด 1000 ซีซี

- 3.2.11 แม่พิมพ์ (Punch and die) ใช้ในการขึ้นรูปเซรามิก
- 3.2.12 กระดาษฟอยล์ (Foil)
- 3.2.13 เครื่องอัดไฮโดรสิลิกสำหรับขึ้นรูปเซรามิก อัดแรงดันได้สูงสุด 1000 kgf/cm^3
- 3.2.14 เตาเผาสาร
- 3.2.15 เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer)
- 3.2.16 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด (SEM)
- 3.2.17 เครื่อง LCR สำหรับวัดสมบัติโดยอิเล็กทริก
- 3.2.18 เครื่อง Computer controlled modified sawyer tower circuit principle สำหรับวัดสมบัติเพื่อเรอิเล็กทริก
- 3.2.19 เครื่อง Vibrating Sample Magnetometer (VSM) เพื่อวัดสมบัติทางแม่เหล็ก (M-H loop)

3.3 วิธีการทดลอง

ขั้นตอนการเตรียมผงผลึกและเซรามิก BCTS-Fe มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 การเตรียมผงผลึก BCTS

1. ชั้นสารตั้งต้น $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, TiO_2 , SnO_2 โดยใช้วิธีทางปริมาณสารสัมพันธ์
2. นำสารที่ได้มาระਸມกันในกระป๋องพลาสติกที่มีลูกบด (ZrO_2) ทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร โดยเติมเนาานอลลงไปให้ทั่วสารซึ่งช่วยให้สารผสมเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ปิดฝาให้สนิท เสร็จแล้วนำไปวางบนเครื่องบดย่อยแบบลูกบดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
3. เมื่อครบ 24 ชั่วโมงแล้วเทสารลงบนตะแกรงลวดที่วางอยู่บนบีกเกอร์เพื่อล้างแยกของผสมออกจากเม็ดบด และจึงนำ magnetic stirrer สำหรับคนสารให้เข้ากันใส่ลงในบีกเกอร์แล้วนำกระดาษฟอยล์ที่เจาะรูมาปิดก่อนจะนำไปตั้งบน hot plate เพื่อระเหยเอทานอลออก โดยปรับให้ร้อนประมาณ 120 องศาเซลเซียส
4. เมื่อทำให้เอทานอลระเหยออกจากสารไปหมดแล้ว จึงนำสารไปทำการอบโดยใช้อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
5. นำสารที่แห้งแล้วมาบดโดยใช้ครกหยก (agate) จากนั้นนำผงสารที่ได้คัดขนาด (sieving)
6. นำผงผลึก BCTS ไปซึ่งบนเครื่องซึ่ง 4 ตำแหน่ง พร้อมด้วยไกลซีนในอัตราส่วน BCTS 1:2 หลังจากนั้นนำมำบดในครกหยก ให้สารกับไกลซีนเข้ากัน
7. นำสารที่ผงแล้วไปเผาแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

แผนผังขั้นตอนการเตรียมพลาสติก BCTS

ซึ่งสารตั้งต้น $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, TiO_2 , SnO_2 โดยใช้วิธีทางปริมาณสารสัมพันธ์

นำไปบดย่อยแบบลูกนอลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ทำให้แห้งและคัดขนาด

นำผง BCTS ไปผสมกับไกลเชิน ในอัตราส่วน 1:2

นำผงผสมไปเผาแคลใจน์ที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

ตอนที่ 2 การเตรียมเซรามิก BCTS- Fe_2O_3

1. นำผงหลัก BCTS ที่เผาเคลื่อนในตอนที่ 1 มาเติม Fe_2O_3 ที่ปริมาณ 0-0.5 wt% แล้วนำมาใส่ตัวประสาน (PVA) 3% ผสมในกระปองพลาสติกที่มีลูกบด (ZrO_2) รูปทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร โดยเติมເອຫານอลให้ท่วมสาร จากนั้นจึงนำกระปองพลาสติกวางบนเครื่องบดอย่างเบบลูกบดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
2. เทสารลงบนตะแกรงลวดที่วางอยู่บนบีกเกอร์ที่มีแผ่นเหล็กอยู่ข้างใน เพื่อถ้าง่ายของผสมออกจากเม็ดบด แล้วนำสารที่ได้ไปตั้งไว้บนแผ่นให้ความร้อนโดยปรับความร้อนประมาณ 120 องศาเซลเซียส จนເອຫານอุณหภูมิไปหมด จากนั้นนำสารไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
3. นำสารที่ได้มานดโดยใช้กรวยแกะ (agate) จากนั้นนำผงสารที่ได้มาคัดขนาด (sieving) จนได้ผงสารที่ละเอียด
4. นำสารมาอัดขึ้นรูปโดยใช้ความดันที่ 80 MPa เป็นเวลา 30 วินาที จะได้เม็ดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร
5. นำขั้นงาน BCTS- $x\text{Fe}_2\text{O}$ ที่ขึ้นรูปแล้ว มาจัดเรียงไว้ในถ้วยอัลูมีนิยาและใช้ผงอะลูมีนิยาเป็นตัวนำความร้อน
6. นำเม็ด BCTS- $x\text{Fe}_2\text{O}$ ไปเผาในเตอร์ที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
7. หลังจากการเผาชิ้นเตอร์แล้ว นำเม็ดเซรามิกที่ได้มาตรวจสอบโครงสร้างไฟส่องด้วยเครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) โครงสร้างจะภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ตรวจสอบสมบัติโดยอิเล็กทริกด้วยเครื่อง LCR เครื่องวัดวงอิสเทอร์ชิส (computer-controlled modified Sawyer-Tower circuit (Radiant, PLC2-1014346)) และเครื่องวัดสมบัติทางแม่เหล็ก (Vibrating Sample Magnetometer (Versa Lab, Quantum Design))

แผนผังขั้นตอนการเตรียมเซรามิก BCTS-xFe₂O₃

นำผงผลึก BCTS ที่เผาเคลือบในตอนที่ 1 มาเติม Fe₂O₃ ที่ปริมาณ 0 -0.5 0wt%



เติม PVA 3% แล้วนำไปปิดย่ออยแบบลูกบอลเป็นเวลา 12 ชั่วโมง



ทำให้แห้งและคัดขนาด



นำสารมาอัดขึ้นรูปโดยใช้ความดันที่ 80 MPa เป็นเวลา 30 วินาที



ขันตอร์ที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



ตรวจสอบโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแม่เหล็กของเซรามิก

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer: XRD) ของเซรามิกแบบเรียมแคลเซียมสแตนเนตไททาเนตที่เติมเหล็ก (III) ออกไซด์ ($BCTS-xFe_2O_3$)

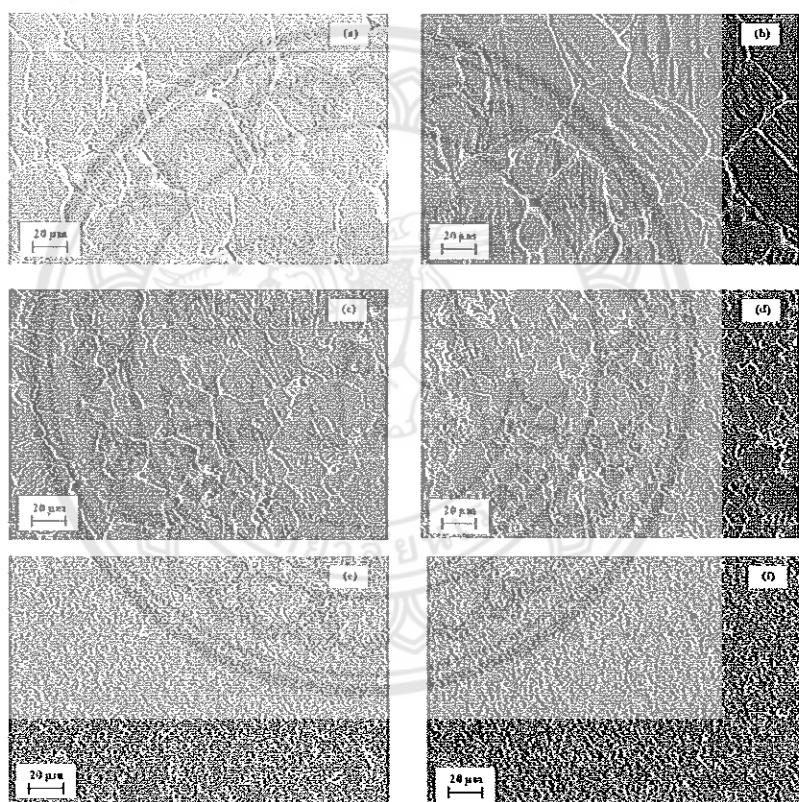
รูปที่ 11 (a)-(c) แสดงแบบรูปการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ที่อุณหภูมิห้องของเซรามิก ($Ba_{0.97}Ca_{0.03}(Ti_{0.94}Rn_{0.06})O_3$) ที่เติม Fe_2O_3 ($BCTS-xFe_2O_3$) ปริมาณ 0 ถึง 0.5 wt% ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาใหม่สถานะของแข็ง โดยใช้เกลชีนเป็นเชื้อเพลิง ในอัตราส่วน 1:2 แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 1100 องศา เชลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และชินเทอร์ที่อุณหภูมิ 1400 องศาเชลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเป็น 5 องศาเชลเซียสต่อนาที ที่มุ่ง 20 ตั้งแต่ 20 ถึง 70, 38 ถึง 40 และ 44 ถึง 46 องศา ตามลำดับ จากรูป 11 (a) พบว่าเซรามิกแสดงโครงสร้างเฟสแบบเพอร์โวฟไกท์ที่บริสุทธิ์ในทุกตัวอย่าง โดยสามารถคำนวณหาร้อยละความบริสุทธิ์ได้จากการที่ 18

$$\% \text{ perovskite phase} = \frac{I_{\text{perovskite}}}{I_{\text{perovskite}} + I_{\text{impurity}}} \times 100 \quad (18)$$

เมื่อ $I_{\text{perovskite}}$ คือ พีคการเลี้ยวเบนของเฟสแบบเพอร์โวฟไกท์ที่มีความเข้มสูงสุด
 I_{impurity} คือ พีคการเลี้ยวเบนของเฟสเปลกปลอกที่มีความเข้มสูงสุด

สำหรับการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างเฟสของเซรามิก $BCTS-xFe_2O_3$ สามารถพิจารณาได้จากมุ่ง 20 ประมาณ 39 และ 45 องศา ดังแสดงในรูปที่ 1 (b) และ 1 (c) ตามลำดับ โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างเทหะรังโgnัล (JCPDS หมายเลข 74-1960) จะแสดงพีคเดียวของระบบการเลี้ยวเบน $(111)_T$ ที่มุ่งประมาณ 39 องศา และพีคคู่ของระบบการเลี้ยวเบน $(002)/(200)_T$ ที่มุ่งประมาณ 45 องศา สำหรับโครงสร้างօร์โธรอมบิก (JCPDS หมายเลข 81-2200) จะแสดงพีคคู่ของระบบการเลี้ยวเบน $(102)/(120)_O$ ที่มุ่งประมาณ 39 องศา และพีคคู่ของระบบการเลี้ยวเบน $(022)/(200)_O$ ที่มุ่งประมาณ 45 องศา ในกรณีโครงสร้างคิวบิก (JCPDS หมายเลข 031-0174) จะแสดงพีคเดียวของระบบการเลี้ยวเบน $(111)_C$ ที่มุ่งประมาณ 39 องศา และพีคเดียวของระบบการเลี้ยวเบน $(200)_C$ ที่มุ่งประมาณ 45 องศา ในงานวิจัยนี้เซรามิก $BCTS$ แสดงเฟสร่วมระหว่างเทหะรังโgnัล (T) และօร์โธรอมบิก (O) โดยพีคแสดงความไม่สมมาตรและการแยกของพีค ที่มุ่งประมาณ 39 และ 45 องศา ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ

รูปที่ 12 (a)-(f) แสดงโครงสร้างจุลภาคของเซรามิก $BCTS-xFe_2O_3$ ที่ผ่านการขัดและกัดด้วยความร้อน พบร่วมกันของมีลักษณะหลายเหลี่ยมและมีการเจริญเติบโตแบบรีทิศทาง เมื่อปริมาณ Fe_2O_3 เพิ่มขึ้น ขนาดเกรนเฉลี่ยลดลงจาก 31.70 เป็น $1.22 \mu m$ โดยขนาดเกรนเฉลี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วที่ปริมาณ Fe_2O_3 ตั้งแต่ 0.4 ถึง 0.5 wt% ดังแสดงในตารางที่ 4.3 การลดลงของขนาดเกรนเฉลี่ยจากเกิดจากซ่องว่างของออกไซเจน (Fe^{3+} แทนที่ใน Ti^{4+} ที่ตำแหน่ง B) ซึ่งทำให้เกิดการสะสมของไอออน Fe ที่บริเวณขอบเกรนส่งผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเกรน [16] จากผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเติม Fe_2O_3 น้ำมีผลอย่างมากต่อลักษณะโครงสร้างจุลภาคและขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิก BCTS ดังแสดงในตารางที่ 4.3



รูปที่ 4.2 โครงสร้างจุลภาคของเซรามิก $BCTS-xFe_2O_3$ ที่ได้จากการขัดด้วยกรด (a) 0, (b) 0.1, (c) 0.2, (d) 0.3, (e) 0.4 และ (f) 0.5 wt%

4.3 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของเซรามิกแบบเรียมแคลเซียมสแตนเนตไททานेटที่เติมเหล็ก (III) ออกไซด์ ($BCTS-xFe_2O_3$)

เมื่อทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น และร้อยละการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิก BCTS ที่เติม Fe_2O_3 ปริมาณต่างๆ พบร่วมกันของมีลักษณะหลายเหลี่ยมและร้อยละการหดตัวเชิงเส้นของเซรามิก

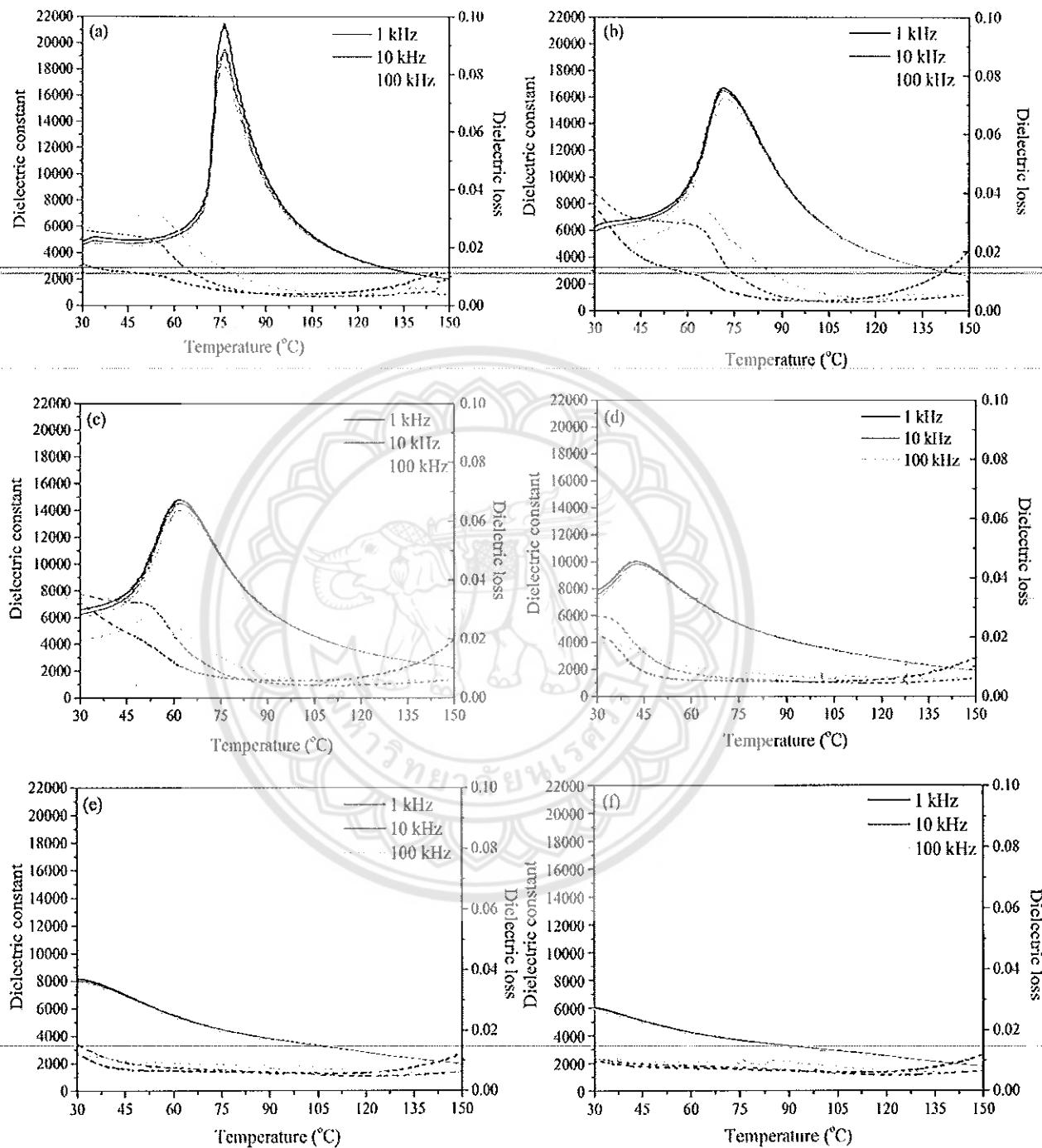
หนาแน่นลดลงจาก 5.91 เป็น 5.59 g/cm^3 ในขณะที่ร้อยละการหดตัวเชิงเส้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 15.38% เป็น 17.22% สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างจุลภาค ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ความหนาแน่นและร้อยละการหดตัวของเซรามิก $\text{BCTS}-x\text{Fe}_2\text{O}_3$

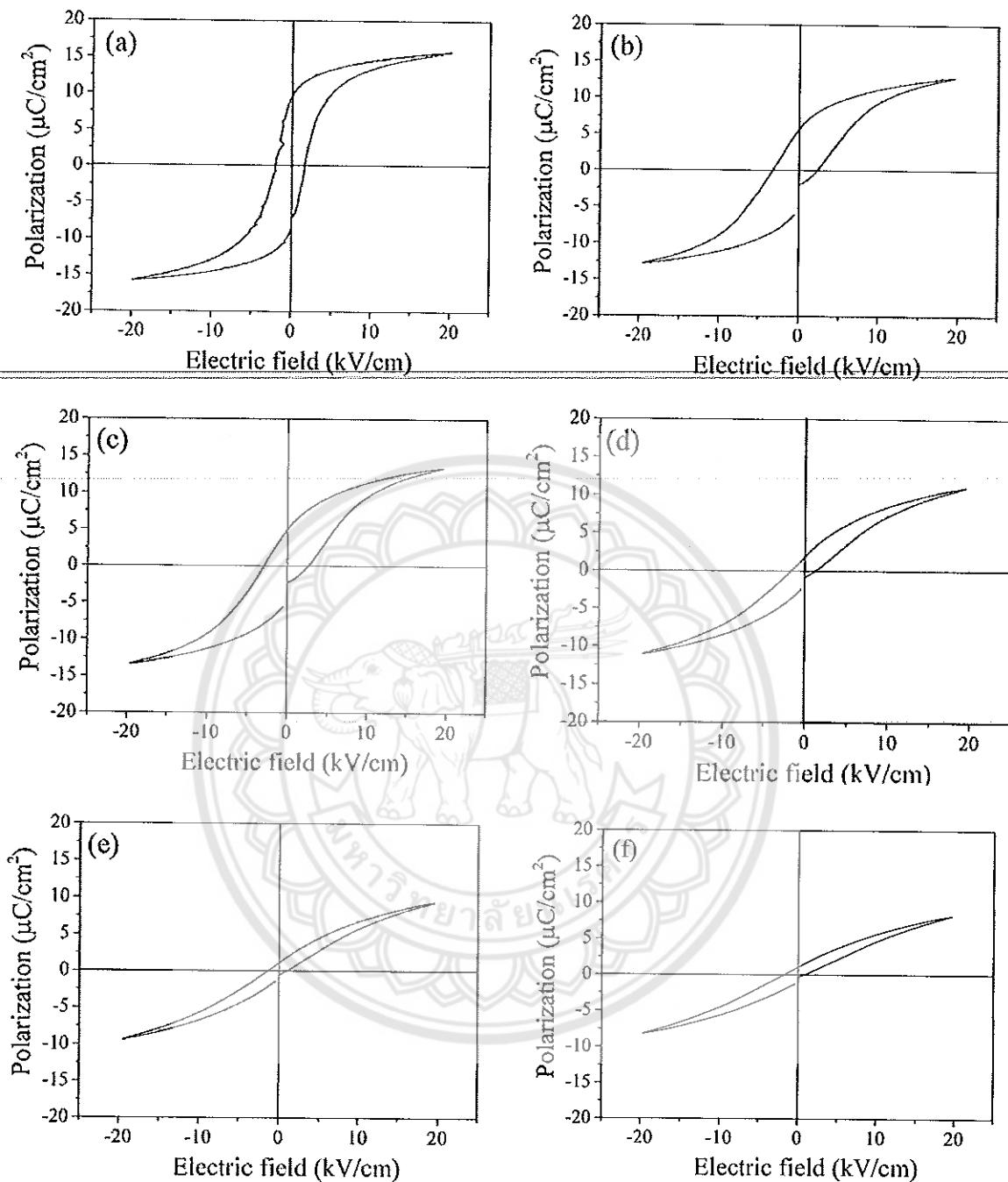
$\text{BCTS}-x\text{Fe}_2\text{O}_3$ (wt%)	ขนาดเกรนเฉลี่ย (μm)	ความหนาแน่น (g/cm^3)	ร้อยละการหดตัวเชิง เส้น (%)
0	31.70	5.91	15.38
0.1	29.08	5.86	16.24
0.2	16.86	5.80	16.82
0.3	9.10	5.79	17.04
0.4	1.61	5.70	17.16
0.5	1.22	5.59	17.22

4.4 ผลการวิเคราะห์สมบัตต์โดยอิเล็กทริกของเซรามิกแบบเรียบแฉลเฉี่ยมสแตนเนตไทด์ที่เติมเหล็ก (III) ออกไซด์ ($\text{BCTS}-x\text{Fe}_2\text{O}_3$)

รูปที่ 13 (a)-(f) แสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียโดยอิเล็กทริกของเซรามิก $\text{BCTS}-x\text{Fe}_2\text{O}_3$ วัดที่ความถี่ 1, 10 และ 100 kHz ในช่วงอุณหภูมิ 30 ถึง 150 องศาเซลเซียส พบร่วมค่าคงที่โดยอิเล็กทริกที่ได้เมื่อขึ้นกับความถี่สอดคล้องกับพฤติกรรมของเฟริโออิเล็กทริกแบบปกติ โดยทั่วไปเซรามิก BT จะแสดงค่าคงที่โดยอิเล็กทริก 2 พีค พีคแรกเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำสุดคล้องกับการเปลี่ยนเฟสจากออร์โรรอมบิกเฟริโออิเล็กทริกเป็นเทหาระโภนลัฟเฟริโออิเล็กทริก (T_{0-T}) พีคที่สองเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าคืออุณหภูมิคูรี (T_c) สอดคล้องกับการเปลี่ยนเฟสจากเทหาระโภนลัฟเฟริโออิเล็กทริกเป็นซูడิคิวบิกพาราอิเล็กทริก [17] ในงานวิจัยนี้พบว่าพีค T_{0-T} และ T_c มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ถังเกิดได้ว่า เมื่อปริมาณ Fe_2O_3 เพิ่มขึ้น จะไม่สามารถสังเกตพีค T_{0-T} ได้ (รูปที่ 13 (a) และ (b)) และเมื่อปริมาณ Fe_2O_3 เป็น 0.5 wt% จะไม่สามารถสังเกตพีค T_c ได้ (รูปที่ 13 (a)-(e)) เนื่องจากพีคทั้งกล่าวเลื่อนมาอยังอุณหภูมิที่ต่ำกว่า อุณหภูมิห้อง ซึ่งต่ำกว่าขีดจำกัดของเครื่องมือวัดที่จะสามารถวัดได้ สอดคล้องกับผล XRD ที่อุณหภูมิห้อง (เฟสซูడิคิวบิก) หากพิจารณาเรื่องรัศมีไอออน การเติม Fe_2O_3 (Fe^{3+}) ที่มีรัศมีไอออนเท่ากับ 0.645 อังสตรอม มีแนวโน้มที่จะเข้าไปแทนที่ Tl^{4+} ที่มีรัศมีไอออนเท่ากับ 0.605 อังสตรอม เนื่องจากประจุทั้งสองมีรัศมีไอออนใกล้เคียงกัน การแทนที่กรณีดังกล่าวจะส่งผลต่อไอออนตำแหน่ง B และ O ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวในโครงสร้างแลตติชของเซรามิก $\text{BCTS}-x\text{Fe}_2\text{O}_3$ [18] ในส่วนของค่าคงที่โดยอิเล็กทริกค่า (ϵ_c) และการสูญเสียโดยอิเล็กทริก ($\tan\delta$) ที่ T_c มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อปริมาณ Fe_2O_3 เพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.4 ซึ่งสอดคล้องกับผล XRD, SEM และความหนาแน่น



รูปที่ 4.4 ค่าคงที่ไดอีเล็กทริก (ϵ) และค่าการสูญเสียไดอีเล็กทริก ($\tan\delta$) ของเซรามิก BCTS- x Fe₂O₃
 (a) 0, (b) 0.1, (c) 0.2, (d) 0.3, (e) 0.4 และ (f) 0.5 wt% วัดที่ความถี่ 1, 10 และ 100 kHz



รูปที่ 4.5 สภาพขั้นคงค้าง (P_r) และสนามไฟฟ้าลบลัง (E_C) ของเซรามิก BCTS-xFe₂O₃ (a) 0, (b) 0.1, (c) 0.2, (d) 0.3, (e) 0.4 และ (f) 0.5 wt% ภายใต้สนามไฟฟ้า 20 kV/cm

บทที่ 5

บทสรุป

สรุปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของการเติม Fe_2O_3 (0 ถึง 0.5 wt%) ที่มีต่อการก่อเกิดเฟส โครงสร้าง
จุดภาค สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิก BCTS ที่เตรียมด้วยเทคนิคการเผาใหม้แบบส่วนชะ
ของแข็ง โครงสร้างเฟสของเซรามิก $\text{BCTS}-x\text{Fe}_2\text{O}_3$ แสดงเฟสเดียวเพอร์อฟสไกต์ในทุกตัวอย่าง เมื่อเติม
 Fe_2O_3 ในปริมาณ 0 ถึง 0.3 wt% เซรามิกมีลักษณะเฟสร่วมระหว่างออร์โธอมบิกและเทหะโนนัล โดย
ที่โครงสร้างเฟสแสดงลักษณะอูโดคิวบิกเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณ Fe_2O_3 เพิ่มขึ้นจาก 0.4 ถึง 0.5 wt% โดย[†]
ขนาดเกรนเฉลี่ย ความหนาแน่นและพฤติกรรมไดอิเล็กทริกของเซรามิก $\text{BCTS}-x\text{Fe}_2\text{O}_3$ มีแนวโน้มลดลง
เมื่อปริมาณ Fe_2O_3 เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลของการเติม Fe_2O_3 ยังส่งผลให้ค่า P_r และ E_c ลดลง ซึ่งอาจเป็น[†]
ผลมาจากการลดลงของขนาดเกรนเฉลี่ยและความหนาแน่น เซรามิก BCTS แสดงพฤติกรรมแม่เหล็กแบบ
ไดโอดเมื่อเติม Fe_2O_3 เซรามิกแสดงพฤติกรรมแม่เหล็กแบบพารา



บรรณานุกรม

- [1] H. Gene. Mechanical Properties of x PMN-($1-x$)PZT Ceramic Systems. *Journal of the American Ceramic*. 1999;82(4):797-818. doi:10.1111/j.1151-2916.1999.tb01840.x
- [2] W. Hong, Z. Deyi. Preparation of PNN-PZT Ceramics and Piezoelectric Characteristics. *Applied Mechanics and Materials*. 2015;700:132-135.doi:10.4028/www.scientific.net/amm.700.1
- [3] C. Suphornphun, B. Theerachai. Optimum Conditions for Preparation of High-Performance $(\text{Ba}_{0.97}\text{Ca}_{0.03})(\text{Ti}_{0.94}\text{Sn}_{0.06})\text{O}_3$ Ceramics by Solid-State Combustion. *Electronic Materials*. 2017;46(8): 5215-5224. doi:10.1007/s11664-017-5533-6
- [4] B. Theerachai, C. Suphornphun, P. Supree. Excellent piezoelectric and ferroelectric Properties of KNLNTS ceramics with Fe_2O_3 doping synthesized by the solid state combustion technique. *Journal of the Alloys and Compounds*. 2016;682:14-21.doi:10.1016/j.jallcom.2016.04.285
- [5] G. Jinming, X. Fang, S. Xunzhong. High-Performance Small-Amount Fe_2O_3 -Doped $(\text{K},\text{Na})\text{NbO}_3$ -Based Lead-Free Piezoceramics with Irregular Phase Evolution. *The American Ceramic Society*. 2016;99(7):2341-2346. DOI: 10.1111/jace.14230
- [6] A. Thongtha and T. Bongkarn, Phase formation and microstructure of barium zirconate ceramics prepared using the combustion technique. *Ferroelectrics*. 383 (2009) 33-39.
- [7] P. Panya, N. Vittayakorn, N. Phungjitt and T. Bongkarn, The structural phase and microstructure of perovskite $\text{Ba}(\text{Ti}_{1-x}\text{Zr}_x)\text{O}_3$ ceramics using the combustion Route. *Func. Mater. Lett.*, 2(4) (2009) 169-174.
- [8] P. Julphunthong and T. Bongkarn, Phase formation, microstructure and dielectric properties of $\text{Ba}(\text{Zr}_{0.1}\text{Ti}_{0.9})\text{O}_3$ ceramics prepared via the combustion technique. *Curr. Appl. Phys.* 11(3) (2011) 60-65.
- [9] G. A. Smolenskii and A. I. Agranovuskaya, Dielectric polarization of a number of complex compounds. *Sov. Phys. Solid State*. 1, (1959) 14297.
- [10] H. David and R. Robert, Physics, past 2. 1st ed, John Wiley & Sons (1962).
- [11] A. J. Moulson and J. M. Herbert, *Electroceramics: Materials, Properties and Application*. 1st ed, Chapman and Hall (1990)
- [12] สุรินทร์ ลิ่มปนาท และศรีไนน์ ขุนทด. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแทรกชัน, เครื่องมือวิจัยทางวัสดุ:

ทฤษฎี และการทำงานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) (หน้า 309-322)

- [13] กฤษณ ศิวเดศกมล. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุรังสีเอกซ์, เครื่องมือวิจัยทางวัสดุ: ทฤษฎีและการทำงานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) (หน้า 289-305).
- [14] D. Damjanovic, Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 1998;3(469).
- [15] Cai-Xia Lia,b, Bin Yanga,n, Shan-Tao Zhange, et al. Phase transition,microstructure and electrical properties of Fe doped $Ba_{0.70}Ca_{0.30}TiO_3$ lead-free piezoelectric ceramics. Ceramics International. 2013;39:8701–8708.doi:10.1016/j.ceramint.2013.04.052
- [16] Y. Hee-Wook, K. Sang-Mo, H. Jae-Geun. Microstructure and dielectric properties of Fe^{3+} -doped $Ba(Zr,Ti)O_3$ ceramics. Current Applied Physics. 2009;9(4):875-879. doi:10.1080/10584587.2013.778733
- [17] J. Piyaporn, S. Satapond, B. Suwapietcha. Ferroelectric, Piezoelectric and Dielectric Behaviors of CoO- and Fe_2O_3 -Doped BCZT Ceramics. Physica Status Solidi. 2018;1701023. doi:10.1002/pssa.201701023
- [18] B. Theerachai, C. Suphornphun, P. Supree. Excellent piezoelectric and ferroelectric properties of KNLNTS ceramics with Fe_2O_3 doping synthesized by the solid state combustion technique. Journal of the Alloys and Compounds. 2016;682:14-21. doi:10.1016/j.jallcom.2016.04.285
- [19] W. Tao, L. You, W. Dongmei, , et al. Cycling- and heating-induced evolution of piezoelectric and ferroelectric properties of CuO-doped $K0.5Na0.5NbO_3$ ceramic. Journal of the American Ceramic Society. 2018. doi:10.1111/jace.15931
- [20] C. Suphornphun, B. Theerachai. Optimum Conditions for Preparation of High-Performance $(Ba_{0.97}Ca_{0.03})(Ti_{0.94}Sn_{0.06})O_3$ Ceramics by Solid-State Combustion. Electronic Materials. 2017;46(8): 5215-5224. doi:10.1007/s11664-017-5533-6